

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges
Eigentum

Internationales Büro

(43) Internationales
Veröffentlichungsdatum
31. Oktober 2013 (31.10.2013)



(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2013/160138 A1

(51) Internationale Patentklassifikation:
G02B 26/08 (2006.01)

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2013/057824

(22) Internationales Anmeldedatum:
15. April 2013 (15.04.2013)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
10 2012 206 609.8 23. April 2012 (23.04.2012) DE
61/636,816 23. April 2012 (23.04.2012) US

(71) Anmelder: **CARL ZEISS SMT GMBH** [DE/DE];
Rudolf-Eber-Strasse 2, 73447 Oberkochen (DE).

(72) Erfinder: **VÖLCKER, Martin**; Zanger Hauptstrasse 15,
89551 Königsbronn (DE). **FELDMANN, Heiko**; Alfred-
Delp-Strasse 6, 73430 Aalen (DE). **HILLERICH, Bernd**;
Zeitblomstrasse 31/1, 89073 Ulm (DE).

(74) Anwalt: **RAU, SCHNECK & HÜBNER**; Königstrasse 2,
90402 Nürnberg (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,

AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW,
BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK,
DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM,
GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN,
KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD,
ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI,
NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU,
RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ,
TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA,
ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW,
GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ,
TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ,
RU, TJ, TM), europäisches (AL, AT, BE, BG, CH, CY,
CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT,
LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE,
SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA,
GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Erklärungen gemäß Regel 4.17:

— Erfindererklärung (Regel 4.17 Ziffer iv)

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz
3)

(54) Title: BEAM GUIDING OPTICAL UNIT FOR A MULTI-BEAM SYSTEM

(54) Bezeichnung : STRAHLFÜHRUNGSOPTIK FÜR EIN VIELSTRAHLSYSTEM

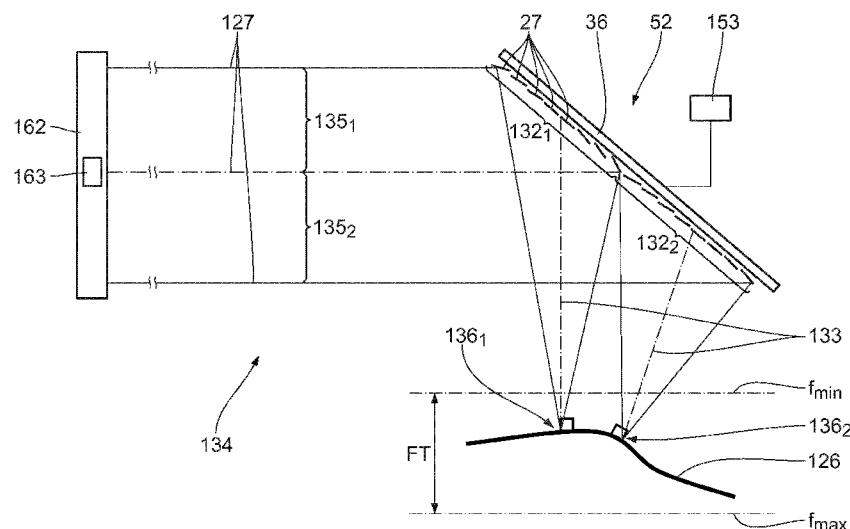


Fig. 20

(57) Abstract: The invention relates to an optical multi-beam system (1; 125) for processing and/or examining a surface (8; 126), comprising a component (52) with a plurality of displaceable mirror elements (27), by means of which different beams (135i) can be focused onto the surface (6; 126) into different foci (136i).

(57) Zusammenfassung: Ein optisches Vielstrahlssystem (1; 125) zur Bearbeitung und/oder Untersuchung einer Oberfläche (8; 126) umfasst ein Bauelement (52) mit einer Vielzahl von verlagerbaren Spiegel-Elementen (27), mittels welcher unterschiedliche Strahlen (135i) in unterschiedliche Foki (136i) auf die Oberfläche (6; 126) fokussierbar sind.

WO 2013/160138 A1

Strahlführungsoptik für ein Vielstrahlssystem

Der Inhalt der deutschen Patentanmeldung DE 10 2012 206 609.8 wird durch Bezugnahme hierin aufgenommen.

5

Die Erfindung betrifft eine Strahlführungsoptik für ein Vielstrahlssystem. Die Erfindung betrifft weiterhin ein optisches Vielstrahlssystem zur Bearbeitung und/oder Untersuchung einer Oberfläche. Außerdem betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Bearbeitung und/oder Untersuchung einer

10 Oberfläche mit einem derartigen Vielstrahlssystem.

Ein optisches Bauelement mit einem eine Mehrzahl von aktuatorisch verlagerten Einzelspiegeln umfassenden Spiegel ist bekannt aus der US 6,658,084 B2, der WO 2009/100856 A1, der WO 2010/049076 A2 und der

15 US 2007/0053673 A1. Ein derartiges Bauelement bildet eine Strahlführungsoptik.

Eine Aufgabe der Erfindung besteht darin, eine derartige Strahlführungsoptik zu verbessern. Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des Anspruchs

20 1 gelöst.

Der Kern der Erfindung besteht darin, eine Strahlführungsoptik derart auszubilden, dass unterschiedliche Teilstrahlen einer Beleuchtungsstrahlung in unterschiedliche Foki auf eine Oberfläche fokussierbar sind. Hierdurch

25 wird die Flexibilität einer derartigen Strahlführungsoptik wesentlich verbessert.

Bei den unterschiedlichen Foki kann es sich insbesondere um räumlich getrennte Foki handeln. Hierbei gelten zwei Foki als räumlich getrennt, wenn

- 2 -

die Intensität des einen Fokus nach Normierung der beiden Strahlen auf gleiche Strahlenintensität zur Intensität des anderen Fokus im Bereich derselben optischen Ebene höchstens 1 % beiträgt.

- 5 In einem Vielstrahlssystem können Teilstrahlen eine Vielzahl von räumlich getrennten Foki erzeugen. Die Foki zweier Teilstrahlen können jedoch auch teilweise überlappen oder vollständig zusammenfallen.

- Vorzugsweise ist das optische Bauelement als mikroelektromechanisches System (MEMS) mit einer Vielzahl von Mikrospiegeln ausgebildet. Die Mikrospiegel können insbesondere als Multispiegel-Array (Multi Mirror Array, MMA) ausgebildet sein. Derartige Systeme und Arrays ermöglichen eine sehr flexible Strahlführung. Die linearen Abmessungen der Mikrospiegel liegen insbesondere im Bereich von 10 μm bis 10 mm.
- 15

Eine weitere Aufgabe der Erfindung besteht darin, ein optisches Vielstrahlssystem zur Bearbeitung und/oder Untersuchung zu verbessern. Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des Anspruchs 3 gelöst.

- 20 Die Vorteile entsprechen den vorhergehend für die Strahlführungsoptik beschriebenen.

- Die Strahlungsquelle des Vielstrahlsystems kann ein- oder mehrkanalig ausgebildet sein. Sie kann insbesondere einen einzigen oder mehrere unabhängige Teilstrahlen erzeugen. Die Strahlungsquelle kann insbesondere an den vorgesehenen Verwendungszweck des optischen Vielstrahlsystems angepasst ausgewählt sein. Als Strahlungsquelle kann insbesondere ein Laser dienen. Als Strahlungsquelle kann auch eine LED-Strahlungsquelle, Laser-
- 25

- 3 -

dioden(-arrays), eine Entladungslampe, eine Halogenlampe oder eine EUV-Strahlungsquelle dienen.

Vorzugsweise ist ein einziger einfallender Strahl mittels der Strahlführungsoptik des optischen Vielstrahlsystems in mehrere Foki fokussierbar. Ein einziger Strahl kann insbesondere in mindestens zwei, insbesondere mindestens drei, insbesondere mindestens fünf, insbesondere mindestens zehn Foki fokussierbar sein. Hierbei können die Foki räumlich getrennt sein. Sie können auch teilweise überlappend sein. Sie sind insbesondere mittels der Strahlführungsoptik unabhängig voneinander veränderbar. Die einzelnen Foki sind ausgehend von der Strahlführungsoptik jeweils durch ihre Brennweite und Lage, d. h. durch die Richtung ihres Hauptstrahls charakterisierbar. Mittels der Strahlführungsoptik sind insbesondere die Brennweite und/oder die Lage der Foki unabhängig voneinander veränderbar.

Vorzugsweise ist mittels der Strahlführungsoptik eine Mehrzahl einfallender Strahlen unabhängig voneinander in einen oder mehrere Foki fokussierbar.

Mittels der Strahlführungsoptik ist es insbesondere möglich, zur Beleuchtung der Oberfläche mit einer bestimmten Lichtverteilung die Beleuchtungsstrahlung von der Strahlungsquelle in teilweise überlappende Foki zu fokussieren. Hierdurch wird die Flexibilität der Beleuchtung der Oberfläche weiter vergrößert. Bei den mittels der Strahlführungsoptik zu erzeugenden Lichtverteilungen handelt es sich beispielsweise um eine Airy-Verteilung, um eine Zylinderhutverteilung, um einen Linienfokus, um eine Doppelmaximum-Verteilung und um eine Interferenzmuster-Verteilung. Andere Lichtverteilungen sind ebenfalls möglich.

Durch eine Detektions-Einrichtung zur konfokalen Bestimmung einer Entfernung zwischen dem optischen Bauelement und der zu bearbeitenden Oberfläche wird das Vielstrahlsystem weiter verbessert. Es kann sich hierbei insbesondere um einen konfokalen Autofokus handeln. Dieser kann an
5 eine Steuereinrichtung zur Verlagerung der Spiegel-Elemente zur Strahlführungsoptik rückgekoppelt sein. Die Detektions-Einrichtung kann insbesondere Bestandteil einer Regelschleife sein. Mittels der Regelschleife kann die Fokustiefe der Strahlführungsoptik kontinuierlich derart geregelt werden, dass die Strahlung stets auf die zu bearbeitende und/oder zu unter-
10 suchende Oberfläche fokussiert ist. Die Regelschleife bildet insbesondere eine Autofokus-Einrichtung.

Im Strahlengang zwischen der Strahlungsquelle und dem optischen Bauelement mit dem Mikrospiegel-Array kann mindestens ein Strahlteiler an-
15 geordnet sein.

Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung ist im Strahlengang zwischen dem Mikrospiegel-Array und der zu beleuchtenden Oberfläche ein Raumfilter angeordnet. Der Raumfilter ist insbesondere in einer Zwischenfokusebene angeordnet. Mittels eines derartigen Raumfilters kann die Intensitätsverteilung im Fokus bzw. in den Foki bereinigt werden. Es ist insbesondere möglich, Störlicht, das beispielsweise durch Beugung am Mikrospiegel-Array entsteht, aus dem Strahlengang herauszufiltern.

25 Vorzugsweise ist der Raumfilter als Multispiegel-Array ausgebildet. Dies ermöglicht eine sehr flexible, insbesondere eine verstellbare Beeinflussung der Beleuchtungsstrahlung. Es ist insbesondere möglich, genau die Einzelspiegel im Bereich des Fokus bzw. der Foki so einzustellen, dass das Licht

- 5 -

im Strahlengang weitergeleitet wird und alle anderen Einzelspiegel das Störlicht aus dem Strahlengang hinausleiten.

5 Eine weitere Aufgabe der Erfindung besteht darin, ein Verfahren zur Bearbeitung und/oder Untersuchung einer Oberfläche mit Strahlung zu verbessern.

10 Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des Anspruchs 11 gelöst. Der Kern der Erfindung besteht darin, zur Einstellung eines vorgegebenen Beleuchtungssettings, insbesondere einer vorgegebenen Hauptstrahlrichtung und/oder Brennweite und/oder Fokusform und/oder Intensitätsverteilung einer Mehrzahl von Strahlen (135_i), zumindest bei einem Teil der Spiegelemente eines Multispiegel-Arrays einen Kippwinkel und/oder eine Spiegelhöhe einzustellen.

15 Die Vorteile entsprechen denen, welche für das optische Vielstrahlssystem beschrieben wurden. Beim erfindungsgemäßen Verfahren zur Bearbeitung und/oder Untersuchung einer Oberfläche werden eine Mehrzahl von Strahlen mittels der Spiegel-Elemente der Strahlführungsoptik unabhängig voneinander zu einem zu beleuchtenden Bereich in einer Objektebene geführt, insbesondere in einen oder mehrere Foki fokussiert.

20

Hierbei kann insbesondere zunächst eine räumliche und/oder zeitlich veränderbare Lichtverteilung zur Bearbeitung und/oder Untersuchung der Oberfläche vorgegeben werden, durch die dann durch eine gesteuerte Verlagerung der Spiegel-Elemente erzeugt wird.

25

Bei der Lichtverteilung kann es sich insbesondere um eine eindimensionale, zweidimensionale oder höher dimensionale Lichtverteilung handeln.

- 6 -

Aufgrund der mittels der Strahlführungsoptik verstellbaren Fokustiefe ist insbesondere eine dreidimensionale Lichtverteilung erzeugbar. Hierdurch kann die Lichtverteilung insbesondere sehr flexibel an unebene Oberflächen angepasst werden. Die Lichtverteilung kann außerdem zeitlich veränderbar sein. Dies wird auch als vierdimensionale Lichtverteilung bezeichnet. Als weitere Dimension kann die Lichtverteilung aus unterschiedlichen Wellenlängen zusammengesetzt sein.

Die Lichtverteilung kann insbesondere aus einer Liste möglicher Lichtverteilungen ausgewählt werden. Für mögliche Lichtverteilungen sei auf die Details des Vielstrahlsystems verwiesen.

Bei dem optischen Vielstrahlsystem handelt es sich insbesondere um eine Lasermaterialbearbeitungsanlage, ein System zur Lasermarkierung, ein System zur aufbauenden Herstellung von Strukturen, z. B. durch Lasersintern oder um ein System zur Laserbehandlung, insbesondere für medizinische Zwecke. Es kann sich auch um ein System zur dreidimensionalen Bildaufnahme, insbesondere zur dreidimensionalen Erfassung der topografischen Struktur einer Oberfläche handeln. Es kann sich auch um ein System zur dreidimensionalen Bildaufnahme mit lokaler Photoanregung handeln. Bei diesem auch als Photomanipulation bezeichneten Verfahren kann es vorteilhaft sein, mit einem Vielstrahlsystem an mehreren Stellen gleichzeitig die Probe mit Licht anzuregen. Die Bildaufnahme erfasst dann die Reaktion der Probe auf diese simultanen Anregung. Eine weitere Anwendung nutzt die Einstellbarkeit des Vielstrahlsystems zur flexiblen strukturierten Beleuchtung. Hier wird ein Intensitätsgitter in der Probe erzeugt, das durch Verrechnung von Bildern mit unterschiedlichen Gitterpositionen und -orientierungen eine Auflösungserhöhung erlaubt. Eine andere Anwendung dieser Intensitätsgitter in der Probe ist eine quasi-konfokale Ver-

- 7 -

ringerung der Fokustiefe in einem Weitfeldmikroskop. Auch hier werden Bilder mit unterschiedlichen Gitterpositionen miteinander verrechnet.

Weitere Aufgaben der Erfindung bestehen darin, ein System zur Lasermaterialbearbeitung und ein System zur Mikroskopie mit Vielstrahl-
5 Fotoanregung zu verbessern. Diese Aufgaben werden durch die Merkmale der Ansprüche 14 und 15 gelöst. Die Vorteile ergeben sich aus den vorhergehend beschriebenen.

10 Weitere Details und Einzelheiten der Erfindung ergeben sich aus der Beschreibung mehrerer Ausführungsbeispiele anhand der Zeichnungen. Es zeigen:

15 Fig. 1 schematisch eine Projektionsbelichtungsanlage für die Mikrolithografie mit einer im Meridionalschnitt dargestellten Beleuchtungsoptik und einer Projektionsoptik;

20 Fig. 2 eine Ausleuchtung einer Eintrittspupille der Projektionsoptik in Form eines konventionellen Beleuchtungssettings;

25 Fig. 3 eine Ausleuchtung einer Eintrittspupille der Projektionsoptik in Form eines annularen, also ringförmigen, Beleuchtungssettings;

Fig. 4 eine Ausleuchtung einer Eintrittspupille der Projektionsoptik in Form eines 45°-Quadrupol-Beleuchtungssettings;

- Fig. 5 eine Ausführung einer Beleuchtungsoptik der Projektionsbelichtungsanlage nach Fig. 1 mit einem Multispiegel-Array (MMA) und einem von diesem beleuchteten Pupillenfacettenspiegel;
- 5
- Fig. 6 schematisch eine Aufsicht auf den Pupillenfacettenspiegel nach Fig. 5 mit einer Pupillenfacetten-Ausleuchtung, die einem Beleuchtungssetting entspricht;
- 10
- Fig. 7 die Beleuchtungsoptik nach Fig. 5 mit einer umgestellten Kanalzuordnung des Multispiegel-Arrays zum Pupillenfacettenspiegel;
- 15
- Fig. 8 schematisch eine Aufsicht auf den Pupillenfacettenspiegel nach Fig. 7 mit einer Pupillenfacetten-Ausleuchtung, die einem annularen Beleuchtungssetting entspricht;
- 20
- Fig. 9 die Beleuchtungsoptik nach Fig. 5 mit einer umgestellten Kanalzuordnung des Multispiegel-Arrays zum Pupillenfacettenspiegel;
- Fig. 10 schematisch eine Aufsicht auf den Pupillenfacettenspiegel nach Fig. 9 mit einer Pupillenfacetten-Ausleuchtung, die einem Dipol-Beleuchtungssetting entspricht;
- 25

- Fig. 11
5 schematisch zwei nebeneinander liegende Einzel-
spiegel einer Ausführung eines der Facettenspiegel
der Beleuchtungsoptik nach Fig. 1 bzw. des Multi-
spiegel-Arrays nach Fig. 5, 7 oder 9 in einer ge-
schnittenen Seitenansicht, wobei der in der Fig. 11
links dargestellte Einzelspiegel in einer unverkippten
Neutralstellung und der in der Fig. 11 rechts
dargestellte Einzelspiegel in einer durch den Ak-
tuator verkippten Stellung dargestellt ist;
- 10
Fig. 12 einen Schnitt gemäß Linie XII – XII in Fig. 11;
- Fig. 13a und Fig. 13b
15 schematische Darstellungen der Details der Elek-
troden des Aktuators zur Verlagerung des Spiegel-
Elements und deren Aktivierung gemäß einem
weiteren Ausführungsbeispiel;
- Fig. 14a und Fig. 14b
20 schematische Darstellungen der Details der Elek-
troden des Aktuators zur Verlagerung des Spiegel-
Elements und deren Aktivierung gemäß einem
weiteren Ausführungsbeispiel;
- Fig. 15a und Fig. 15b
25 schematische Darstellungen der Details der Elek-
troden des Aktuators zur Verlagerung des Spiegel-
Elements und deren Aktivierung gemäß einem
weiteren Ausführungsbeispiel;
- Fig. 16 schematisch Verfahrensschritte eines Verfahrens-
ablaufs zur Herstellung von Gegenelektroden eines

- 10 -

Aktuators zur Verlagerung eines Spiegelkörpers des Einzelspiegels in der Ausführung nach den Fig. 11 und 12;

- 5 Fig. 17 schematisch einen Querschnitt durch eine Ausführung eines optischen Bauelements senkrecht zu Reflexionsflächen der Einzelspiegel, wobei zusätzlich zu einer schematisch dargestellten Spiegelplatte mit einer Array-Anordnung der Einzelspiegel eine Ansteuerungsplatine zur Ansteuerung der
- 10 Aktuatore der Einzelspiegel dargestellt ist;
- Fig. 18 schematisch ein Ansteuerungsschema für eine Mehrzahl von Teil-Einzelspiegelarrays des optischen Bauelements;
- 15 Fig. 19 eine Scanoptik mit erweiterter Fokustiefe zur Bearbeitung gekrümmter Flächen;
- 20 Fig. 20 eine Vielstrahl-Scanoptik mit erweiterter Fokustiefe zur Bearbeitung gekrümmter Oberflächen;
- Fig. 21 eine Scanoptik gemäß Fig. 19, mit einem zusätzlichen konfokalen Autofokus,
- 25 Fig. 22 eine Vielstrahl-Scanoptik gemäß Fig. 20 mit parallelem konfokalen Autofokus,

- Fig. 23 eine weitere Ausführungsform eines Vielstrahlssystems zur Erzeugung mehrerer unabhängiger Foki,
- Fig. 23a schematisch die Zuordnung der Einzelspiegel eines Multispiegel-Arrays zu unterschiedlichen Foki im Falle einer periodischen Verteilung,
- Fig. 23b eine Darstellung gemäß Fig. 23a im Falle einer nicht periodischen Verteilung,
- Fig. 24 ein Vielstrahlssystem gemäß Fig. 23 ohne einen Strahlteiler,
- Fig. 25 ein Vielstrahlssystem gemäß Fig. 24 mit einem zusätzlichen Raumfilter in einer Zwischenfokusebene und
- Fig. 26 eine schematische Aufsicht auf den Raumfilter gemäß Fig. 25.

Im Folgenden werden zunächst unterschiedliche Ausführungsformen eines optischen Bauelements und dessen Verwendung in einer Projektionsbelichtungsanlage beschrieben. Weitere Anwendungsmöglichkeiten werden anschließend beschrieben. Fig. 1 zeigt schematisch in einem Meridionalschnitt eine Projektionsbelichtungsanlage 1 für die Mikrolithografie. Für allgemeine Details des Aufbaus der Projektionsbelichtungsanlage 1 sowie deren Bestandteile sei auf die WO 2010/049076 A2 verwiesen. Zur Erleichterung der Erläuterung von Lagebeziehungen wird nachfolgend in ausgewählten Figuren ein globales kartesisches xyz-Koordinatensystem

- 12 -

verwendet. Die x-Achse verläuft in der Fig. 1 senkrecht zur Zeichenebene auf den Betrachter zu. Die y-Achse verläuft in der Fig. 1 nach rechts. Die z-Achse verläuft in der Fig. 1 nach oben.

- 5 Ein Beleuchtungssystem 2 der Projektionsbelichtungsanlage 1 hat neben einer Strahlungsquelle 3 eine Beleuchtungsoptik 4 zur Belichtung eines Objektfeldes 5 in einer Objektebene 6. Das Objektfeld 5 kann rechteckig oder bogenförmig mit einem x/y-Aspektverhältnis von beispielsweise 13/1 gestaltet sein. Belichtet wird hierbei ein im Objektfeld 5 angeordnetes und
10 in der Fig. 1 nicht dargestelltes reflektierendes Retikel, das eine mit der Projektionsbelichtungsanlage 1 zur Herstellung mikro- bzw. nanostrukturierter Halbleiter-Bauelemente zu projizierende Struktur trägt. Eine Projektionsoptik 7 dient zur Abbildung des Objektfeldes 5 in ein Bildfeld 8 in einer Bildebene 9. Abgebildet wird die Struktur auf dem Retikel auf eine
15 lichtempfindliche Schicht eines im Bereich des Bildfeldes 8 in der Bildebene 9 angeordneten Wafers, der in der Zeichnung nicht dargestellt ist.

- Das Retikel, das von einem nicht dargestellten Retikelhalter gehalten ist, und der Wafer, der von einem nicht dargestellten Waferhalter gehalten ist,
20 werden beim Betrieb der Projektionsbelichtungsanlage 1 synchron in der y-Richtung gescannt. Abhängig vom Abbildungsmaßstab der Projektionsoptik 7 kann auch ein gegenläufiges Scannen des Retikels relativ zum Wafer stattfinden.

- 25 Bei der Strahlungsquelle 3 handelt es sich um eine EUV-Strahlungsquelle mit einer emittierten Nutzstrahlung mit einer Wellenlänge im Bereich zwischen 5 nm und 30 nm, insbesondere im Bereich zwischen 10 nm und 15 nm. Es kann sich dabei um eine Plasmaquelle, beispielsweise um eine GDPP-Quelle (Plasmaerzeugung durch Gasentladung, Gas Discharge Pro-

duced Plasma), oder um eine LPP-Quelle (Plasmaerzeugung durch Laser, Laser Produced Plasma) handeln. Auch andere EUV-Strahlungsquellen, beispielsweise solche, die auf einem Synchrotron oder auf einem Free Electron Laser (Freie Elektronenlaser, FEL) basieren, sind möglich.

5

EUV-Strahlung 10, die von der Strahlungsquelle 3 ausgeht, wird von einem Kollektor 11 gebündelt. Ein entsprechender Kollektor ist beispielsweise aus der EP 1 225 481 A bekannt. Nach dem Kollektor 11 propagiert die EUV-Strahlung 10 durch eine Zwischenfokusebene 12, bevor sie auf einen

10 Feldfacettenspiegel 13 mit einer Vielzahl von Feldfacetten 19 trifft. Der Feldfacettenspiegel 13 ist in einer Ebene der Beleuchtungsoptik 4 angeordnet, die zur Objektebene 6 optisch konjugiert ist.

Die EUV-Strahlung 10 wird nachfolgend auch als Nutzstrahlung, Beleuchtungslicht oder als Abbildungslicht bezeichnet.

15

Nach dem Feldfacettenspiegel 13 wird die EUV-Strahlung 10 von einem Pupillenfacettenspiegel 14 mit einer Vielzahl von Pupillenfacetten 29 reflektiert. Der Pupillenfacettenspiegel 14 liegt entweder in der Eintrittspupillenebene der Beleuchtungsoptik 7 oder in einer hierzu optisch konjugierten Ebene. Der Feldfacettenspiegel 13 und der Pupillenfacettenspiegel 14 sind aus einer Vielzahl von auch als Einzelspiegel bezeichneten Spiegel-Elementen 27 aufgebaut, die nachfolgend noch näher beschrieben werden. Dabei kann die Unterteilung des Feldfacettenspiegels 13 in Einzelspiegel

20

25 27 derart sein, dass jede der Feldfacetten 19, die für sich das gesamte Objektfeld 5 ausleuchten, durch genau einen der Einzelspiegel 27 repräsentiert wird. Alternativ ist es möglich, zumindest einige oder alle der Feldfacetten 19 durch eine Mehrzahl derartiger Einzelspiegel 27 aufzubauen. Entsprechendes gilt für die Ausgestaltung der den Feldfacetten 19 jeweils zuge-

ordneten Pupillenfacetten 29 des Pupillenfacettenspiegels 14, die jeweils durch einen einzigen Einzelspiegel 27 oder durch eine Mehrzahl derartiger Einzelspiegel 27 gebildet sein können.

- 5 Die EUV-Strahlung 10 trifft auf die beiden Facettenspiegel 13, 14 unter einem Einfallswinkel auf, der kleiner oder gleich 25° ist. Die beiden Facettenspiegel werden also im Bereich eines normal incidence-Betriebs mit der EUV-Strahlung 10 beaufschlagt. Auch eine Beaufschlagung unter streifen-
- 10 dem Einfall (grazing incidence) ist möglich. Der Pupillenfacettenspiegel 14 ist in einer Ebene der Beleuchtungsoptik 4 angeordnet, die eine Pupillenebene der Projektionsoptik 7 darstellt bzw. zu einer Pupillenebene der Projektionsoptik 7 optisch konjugiert ist. Mithilfe des Pupillenfacettenspiegels 14 einer Übertragungsoptik 15 mit in der Reihenfolge des Strahlengangs für die EUV-Strahlung 10 bezeichneten Spiegeln 16, 17 und 18 werden die
- 15 Feldfacetten 19 des Feldfacettenspiegels 13 einander überlagernd in das Objektfeld 5 abgebildet. Der letzte Spiegel 18 der Übertragungsoptik 15 ist ein Spiegel für streifenden Einfall („Grazing incidence Spiegel“). Die Übertragungsoptik 15 wird zusammen mit dem Pupillenfacettenspiegel 14 auch als Folgeoptik zur Überführung der EUV-Strahlung 10 vom Feldfacettenspiegel 13 hin zum Objektfeld 5 bezeichnet. Das Beleuchtungslicht 10
- 20 wird von der Strahlungsquelle 3 hin zum Objektfeld 5 über eine Mehrzahl von Ausleuchtungskanälen oder Strahlungskanälen geführt. Bei der Beleuchtungsoptik 4 handelt es sich somit um eine Mehrkanaloptik. Sie wird auch als Vielstrahlssystem bezeichnet. Jedem der Ausleuchtungskanäle ist
- 25 eine Feldfacette 19 des Feldfacettenspiegels 13 und eine dieser nachgeordnete Pupillenfacette 29 des Pupillenfacettenspiegels 14 zugeordnet. Die Einzelspiegel 27 des Feldfacettenspiegels 13 und/oder des Pupillenfacettenspiegels 14 sind aktorisch verkipptbar, sodass ein Wechsel der Zuordnung der Pupillenfacetten 29 zu den Feldfacetten 19 und entsprechend eine

geänderte Konfiguration der Ausleuchtungskanäle erreicht werden kann. Es resultieren unterschiedliche Beleuchtungssettings, die sich in der Verteilung der Beleuchtungswinkel des Beleuchtungslichts 10 über das Objektfeld 5 unterscheiden. Beim Beleuchtungssystem 2 handelt es sich insbesondere um ein Vielstrahlssystem.

Zumindest ein Teil der Spiegel-Elemente 27 des Feldfacettenspiegels 13 und/oder des Pupillenfacettenspiegels 14 ist aktuatorisch linear in z-Richtung verlagerbar. Die z-Richtung entspricht hierbei gerade der Richtung einer zentralen Flächennormalen 340 der Spiegel-Elemente 27 in deren Mittelstellung. Bei den linear verlagerbaren Spiegelementen 27 handelt es sich insbesondere zumindest teilweise um die Spiegelemente 27, welche auch verkippter sind.

Durch eine derartige lineare Verlagerung, d.h. durch eine Einstellung der Spiegelhöhe, lässt sich insbesondere die Phase der jeweils von dem Einzelspiegel 27 reflektierten Nutzstrahlung 10 steuern.

Prinzipiell können auch andere Spiegel als die Facettenspiegel 13, 14, insbesondere auch Spiegel der Projektionsoptik 7 mit verlagerbaren Einzelspiegeln 27 ausgebildet sein.

Fig. 2 zeigt ein erstes Beleuchtungssetting, das mit der Beleuchtungsoptik 4 nach Fig. 1 erreicht werden kann und das als konventionelles Beleuchtungssetting oder als kleines konventionelles Beleuchtungssetting bezeichnet wird. Dargestellt ist eine Intensitätsverteilung des Beleuchtungslichts 10 in einer Eintrittspupille der Projektionsoptik 7. Die Eintrittspupille kann maximal bis zu einem kreisförmigen Pupillenrand 20 ausgeleuchtet werden.

Beim konventionellen Beleuchtungssetting wird innerhalb des Pupillenrandes 20 ein hierzu konzentrischer kreisförmiger Pupillenbereich 21 ausgeleuchtet. Ein äußerer Radius S_{out} des konventionellen Pupillen-

5 Ausleuchtungsbereichs verhält sich zum Radius S_{max} des Pupillenrandes 20 wie folgt: $S_{out}/S_{max}=0,8$.

Fig. 3 zeigt die Beleuchtungsverhältnisse bei einem weiteren Beleuchtungssetting, das mit der Beleuchtungsoptik 4 nach Fig. 1 eingestellt werden kann und das als annulares Beleuchtungssetting bezeichnet wird. Aus-

10 geleuchtet wird hierbei ein ringförmiger Pupillenbereich 22. Ein äußerer Radius S_{out} des Pupillenbereichs 22 ist dabei so groß, wie derjenige des Pupillenbereichs 21 beim konventionellen Beleuchtungsring nach Fig. 2. Ein innerer Radius S_{in} verhält sich beim annularen Pupillenbereich 22 zum

15 Radius S_{max} des Pupillenrandes 20 wie folgt: $S_{in}/S_{max}=0,6$.

Fig. 4 zeigt ein weiteres Beleuchtungssetting, das mit der Beleuchtungsoptik 4 nach Fig. 1 eingestellt werden kann und das als 45°-Quadrupol- bzw. 45°-Quasar-Beleuchtungssetting bezeichnet wird. In der Eintrittspupille der

20 Projektionsoptik 7 werden innerhalb des Pupillenrandes 20 vier ringsektorförmige Pupillenbereiche 23 ausgeleuchtet, die in den vier Quadranten der Eintrittspupille angeordnet sind. Jeder der Pupillenbereiche 23 überstreicht dabei um das Zentrum des Pupillenrandes 20 einen Umfangswinkel von 45°. Die Quasar-Pupillenbereiche 23 sind zum Zentrum des Pupillenrandes

25 20 hin von einem inneren Radius S_{in} begrenzt, der dem inneren Radius des annularen Pupillenbereichs 22 nach Fig. 3 entspricht. Nach außen hin sind die Quasar-Pupillenbereiche 23 durch den Pupillenrand 20 begrenzt.

Die verschiedenen Beleuchtungssettings nach den Fig. 2 bis 4 sowie vorgegebene weitere Beleuchtungssettings können über eine entsprechende

- Verkipfung der Einzelspiegel 27 des Feldfacettenspiegels 13 und einen entsprechenden Wechsel der Zuordnung der Facetten 19 des Feldfacettenspiegels 13 zu den Facetten 29 des Pupillenfacettenspiegels 14 erreicht werden. Abhängig von der Verkipfung der Einzelspiegel 27 des Feldfacettenspiegels 13 werden die diesen Einzelspiegeln 27 neu zugeordneten Einzelspiegel 27 des Pupillenfacettenspiegels 14 so durch Verkipfung nachgeführt, dass wiederum eine Abbildung der Feldfacetten 19 des Feldfacettenspiegels 13 in das Objektfeld 5 gewährleistet ist.
- 10 Fig. 5 zeigt eine weitere Darstellung einer Beleuchtungsoptik 24 für die Projektionsbelichtungsanlage 1. Komponenten, die denjenigen entsprechen, die vorstehend unter Bezugnahme auf die Fig. 1 bis 4 bereits erläutert wurden, tragen die gleichen Bezugsziffern und werden nicht nochmals im Einzelnen diskutiert.
- 15 Von der Strahlungsquelle 3, die als LPP-Quelle ausgebildet sein kann, ausgehende Nutzstrahlung 10 wird zunächst von einem ersten Kollektor 25 gesammelt. Bei dem Kollektor 25 kann es sich um einen Parabolspiegel handeln, der die Strahlungsquelle 3 in die Zwischenfokusebene 12 abbildet bzw. das Licht der Strahlungsquelle 3 auf den Zwischenfokus in der Zwischenfokusebene 12 fokussiert. Der Kollektor 25 kann so betrieben werden, dass er vor der Nutzstrahlung 10 mit Einfallswinkeln nahe 0° beaufschlagt wird. Der Kollektor 25 wird dann nahe der senkrechten Inzidenz (normal incidence) betrieben und daher auch als normal incidence-
- 20 (NI-)Spiegel bezeichnet. Auch ein unter streifendem Einfall betriebener Kollektor kann anstelle des Kollektors 25 zum Einsatz kommen.

Der Zwischenfokusebene 12 ist bei der Beleuchtungsoptik 24 ein Feldfacettenspiegel 26 in Form eines Multi- bzw. Mikrospiegel-Arrays (MMA)

als Beispiel für ein optisches Bauelement 52 zur Führung der Nutzstrahlung 10, also des Strahlungsbündels, nachgeordnet. Der Feldfacettenspiegel 26 ist als mikroelektromechanisches System (MEMS) ausgebildet. Er weist eine Vielzahl von matrixartig zeilen- und spaltenweise in einem zweidi-
5 mensionalen Array angeordneten Einzelspiegeln 27 auf. Die Einzelspiegel 27 sind aktuatorisch verlagerbar ausgelegt, wie nachfolgend noch erläutert wird.

Insgesamt weist der Feldfacettenspiegel 26 etwa 100000 der Einzelspiegel
10 27 auf. Je nach Größe der Einzelspiegel 27 kann der Feldfacettenspiegel 26 auch beispielsweise 1000, 5000, 7000 oder auch mehrere hunderttausend, beispielsweise 500000 Einzelspiegel 27 aufweisen.

Vor dem Feldfacettenspiegel 26 kann ein Spektralfilter angeordnet sein, der
15 die Nutzstrahlung 10 von anderen, nicht für die Projektionsbelichtung nutzbaren Wellenlängenkomponenten der Emission der Strahlungsquelle 3 trennt. Der Spektralfilter ist nicht dargestellt.

Der Feldfacettenspiegel 26 wird mit Nutzstrahlung 10 mit einer Leistung
20 von 840 W und einer Leistungsdichte von $6,5 \text{ kW/m}^2$ beaufschlagt.

Das gesamte Spiegel-Array des Facettenspiegels 26 hat einen Durchmesser von 500 mm und ist dicht gepackt mit den Einzelspiegeln 27 ausgelegt. Die Einzelspiegel 27 repräsentieren, soweit eine Feldfacette 19 durch jeweils
25 genau einen Einzelspiegel 27 realisiert ist, bis auf einen Skalierungsfaktor die Form des Objektfeldes 5. Der Facettenspiegel 26 kann aus 500 jeweils eine Feldfacette 19 repräsentierenden Einzelspiegeln 27 mit einer Dimension von etwa 5 mm in der y-Richtung und 100 mm in der x-Richtung gebildet sein. Alternativ zur Realisierung jeder Feldfacette 19 durch genau

- einen Einzelspiegel 27 kann jede der Feldfacetten 19 durch Gruppen von kleineren Einzelspiegeln 27 approximiert werden. Eine Feldfacette 19 mit Dimensionen von 5 mm in der y-Richtung und von 100 mm in der x-Richtung kann z. B. mittels eines 1 x 20-Arrays von Einzelspiegeln 27 der
- 5 Dimension 5 mm x 5 mm bis hin zu einem 10 x 200-Array von Einzelspiegeln 27 mit den Dimensionen 0,5 mm x 0,5 mm aufgebaut sein. Die Flächenabdeckung des kompletten Feldfacetten-Arrays durch die Einzelspiegel 27 kann mindestens 70 %, insbesondere mindestens 80 % betragen.
- 10 Von den Einzelspiegeln 27 des Facettenspiegels 26 wird das Nutzlicht 10 hin zu einem Pupillenfacettenspiegel 28 reflektiert. Der Pupillenfacettenspiegel 28 hat etwa 2000 Pupillenfacetten 29. Die Pupillenfacetten 29 können statisch oder flexibel, das heißt verlagerbar, ausgebildet sein. Diese sind in einer Mehrzahl konzentrischer Ringe nebeneinander angeordnet,
- 15 sodass die Pupillenfacette 29 des innersten Rings sektorförmig und die Pupillenfacetten 29 der sich hieran unmittelbar anschließenden Ringe ringsektorförmig gestaltet sind. In einem Quadranten des Pupillenfacettenspiegels 28 können in jedem der Ringe Pupillenfacetten 29 nebeneinander vorliegen. Jeder der in der Fig. 6 dargestellten Ringsektoren ist wiederum von
- 20 einer Mehrzahl von Einzelspiegeln 27 gebildet.

- Von den Pupillenfacetten 29 wird das Nutzlicht 10 hin zu einem reflektierenden Retikel 30 reflektiert, das in der Objektebene 6 angeordnet ist. Es schließt sich dann die Projektionsoptik 7 an, wie vorstehend im Zusammen-
- 25 hang mit der Projektionsbelichtungsanlage nach Fig. 1 erläutert.

Zwischen dem Facettenspiegel 28 und dem Retikel 30 kann wiederum eine Übertragungsoptik vorgesehen sein, wie vorstehend in Zusammenhang mit der Beleuchtungsoptik 4 nach Fig. 1 erläutert.

Fig. 6 zeigt beispielhaft eine Ausleuchtung der Pupillenfacetten 29 des Pupillenfacettenspiegels 28, mit der angenähert das konventionelle Beleuchtungssetting nach Fig. 2 erreicht werden kann. In den beiden inneren Pupillenfacettenringen des Pupillenfacettenspiegels 28 wird in Umfangsrichtung
5 jede zweite der Pupillenfacetten 29 beleuchtet. Diese alternierende Beleuchtungsdarstellung in der Fig. 6 soll symbolisieren, dass die bei diesem Beleuchtungssetting realisierte Füllungsdichte um einen Faktor 2 geringer ist als bei einem annularen Beleuchtungssetting. Angestrebt wird in den
10 beiden inneren Pupillenfacettenringen ebenfalls eine homogene Beleuchtungsverteilung, allerdings mit um einen Faktor 2 geringerer Belegungsdichte. Die beiden äußeren in Fig. 6 dargestellten Pupillenfacettenringe werden nicht beleuchtet.

15 Fig. 7 zeigt schematisch die Verhältnisse bei der Beleuchtungsoptik 24, soweit dort ein annulares Beleuchtungssetting eingestellt ist. Die Einzelspiegel 27 des Feldfacettenspiegels 26 sind derart aktuatorisch mit Hilfe nachfolgend noch erläuterter Aktuatoren verkippt, sodass auf dem Pupillenfacettenspiegel 28 ein äußerer Ring der ringsektorförmigen Pupillenfacette
20 29 mit dem Nutzlicht 10 beleuchtet ist. Diese Beleuchtung des Pupillenfacettenspiegels 28 ist in der Fig. 8 dargestellt. Die Verkipfung der Einzelspiegel 27 zur Erzeugung dieser Beleuchtung ist in der Fig. 7 am Beispiel eines der Einzelspiegel 27 beispielhaft angedeutet.

25 Fig. 9 zeigt schematisch die Verhältnisse bei der Beleuchtungsoptik 24, soweit dort ein Dipolsetting eingestellt ist.

Fig. 10 zeigt die zu diesem Dipol-Beleuchtungssetting gehörende Ausleuchtung des Pupillenfacettenspiegels 28. Beleuchtet werden zwei Ringsektoren am Übergang zwischen dem zweiten und dritten und am Über-

gang zwischen dem ersten und vierten Quadranten des Pupillenfacettenspiegels 28. Beleuchtet werden dabei Pupillenfacetten 29 der drei äußersten Pupillenfacettenringe in zwei zusammenhängenden Ringsektorbereichen 31 mit einer Umfangserstreckung um ein Zentrum 32a des Pupillenfacettenspiegels 28 von jeweils etwa 55° .

Diese Dipol-Beleuchtung des Pupillenfacettenspiegels 28 wird wiederum durch entsprechende aktuatorische Verkipfung der Einzelspiegel 27 des Feldfacettenspiegels 26 erreicht, wie in der Fig. 9 am Beispiel eines der Einzelspiegel 27 beispielhaft angedeutet.

Zum Umstellen der Beleuchtungssettings entsprechend den Fig. 5, 7 und 9 ist ein Kippwinkel der Einzelspiegel 27 im Bereich von ± 50 mrad erforderlich. Die jeweilige Kippposition für das einzustellende Beleuchtungssetting muss mit einer Genauigkeit von $0,2$ mrad eingehalten werden. Allgemein können die Einzelspiegel 27 um einen Kippwinkel von bis zu ± 200 mrad verkippt sein.

Die Einzelspiegel 27 des Feldfacettenspiegels 26 bzw. die entsprechend aufgebauten Einzelspiegel 27 des Feldfacettenspiegels 13 und des Pupillenfacettenspiegels 14 bei der Ausführung der Beleuchtungsoptik 4 nach Fig. 1 tragen Multilayer-Beschichtungen zur Optimierung ihrer Reflektivität bei der Wellenlänge der Nutzstrahlung 10. Die Temperatur der Multilayer-Beschichtungen sollte 425 K beim Betreiben der Projektionsbelichtungsanlage 1 nicht überschreiten.

Dies wird durch einen Aufbau der Einzelspiegel 27 erreicht, der (vgl. Fig. 11) nachfolgend beispielhaft anhand eines der Einzelspiegel 27 des Feldfacettenspiegels 26 erläutert wird.

In ausgewählten der nachfolgenden Figuren ist ein lokales kartesisches Koordinatensystem eingezeichnet, wobei die xy-Ebene parallel zur Reflexionsfläche 34 in einer nicht verkippten Mittelstellung des Spiegel-

5 Elements 27 verläuft, und die z-Richtung senkrecht hierzu, parallel zu einer zentralen Flächennormalen 340 ist. Die Einzelspiegel 27 der Beleuchtungsoptik 4 bzw. 24 sind in einer evakuierbaren Kammer 32 untergebracht, von der in den Fig. 5 und 11 eine Begrenzungswand 33 angedeutet ist.

10

Die Kammer 32 kommuniziert über eine Fluidleitung 33a, in der ein Absperrventil 33b untergebracht ist, mit einer Vakuumpumpe 33c. Der Betriebsdruck in der evakuierbaren Kammer 32 beträgt einige Pa (Partialdruck H_2). Alle anderen Partialdrücke liegen deutlich unterhalb von 10^{-5} Pa.

15

Der die Mehrzahl von Einzelspiegeln 27 aufweisende Feldfacettenspiegel 26 bildet allgemein ein optisches Bauelement 52 zur Führung eines Bündels der Beleuchtungsstrahlung 10. Das optische Bauelement 52 kann außerdem die evakuierbare Kammer 32 umfassen.

20

Jeder der Einzelspiegel 27 kann eine beaufschlagbare Reflexionsfläche 34 mit Abmessungen von 0,5 mm x 0,5 mm oder auch von 5 mm x 5 mm und größer aufweisen. Allgemein weist die Reflexionsfläche 34 lineare Abmessungen im Bereich von wenigen μm bis einigen mm auf. Bei den Einzelspiegeln 27 handelt es sich insbesondere um Mikrospiegel. Die linearen Abmessungen der Reflexionsfläche 34 liegen insbesondere im Bereich von 10 μm bis 10 mm. Die Reflexionsfläche 34 ist Teil eines Spiegelkörpers 35 des Einzelspiegels 27. Der Spiegelkörper 35 trägt die Mehrlagen- (Multilayer)-Beschichtung.

Die Reflexionsfläche 34 ist plan ausgebildet. Sie weist eine zentrale Flächennormale 340 auf. Die Reflexionsfläche 34 kann auch gekrümmt, insbesondere konvex oder konkav, ausgebildet sein. In diesem Fall sei unter
5 der Flächennormalen 340 der Reflexionsfläche 34 die Normale zur Reflexionsfläche 34 im Bereich ihres geometrischen Schwerpunkts verstanden.

Die Reflexionsflächen 34 der Einzelspiegel 27 ergänzen sich zu einer gesamten Spiegel-Reflexionsfläche des Feldfacettenspiegels 26. Entsprechend können sich die Reflexionsflächen 34 auch zur gesamten Spiegel-
10 Reflexionsfläche des Feldfacettenspiegels 13 oder des Pupillenfacettenspiegels 14 ergänzen.

Der Einzelspiegel 27 umfasst jeweils den Spiegelkörper 35 mit der Reflexionsfläche 34 sowie einen Aktuatorstift 43, welcher über einen Abstandshalter 41 mit dem Spiegelkörper 35 mechanisch verbunden ist. Auf dem
15 Abstandshalter 41 ist ein zentraler Haltekörper 40 angeordnet.

Eine aus einem Substrat gebildete Tragestruktur 36 ist über einen Wärmeleitungsabschnitt 37 mit dem Einzelspiegel 27 mechanisch verbunden (vgl. Fig. 11). Teil des Wärmeleitungsabschnitts 37 ist ein Aufhängungselement
20 38, das eine Verkipfung des Spiegelkörpers 35 relativ zur Tragestruktur 36 zulässt. Das Aufhängungselement 38 lässt eine Verkipfung um mindestens eine quer zur Flächennormalen 340 orientierte Kippachse zu. Das Aufhängungselement 38 lässt außerdem eine lineare Verlagerung des Einzelspiegels 27 in Richtung der Flächennormalen 340 zu. Das Aufhängungselement
25 38 hat einen äußeren Haltering 39, der an der Tragestruktur 36 festgelegt ist. Weiterhin umfasst das Aufhängungselement 38 den gelenkig mit dem Haltering 39 verbundenen inneren Haltekörper 40. Dieser ist zentral unter

- 24 -

der Reflexionsfläche 34 angeordnet. Zwischen dem zentralen Haltekörper 40 und dem Spiegelkörper 35 ist der Abstandshalter 41 angeordnet.

Für Details der Wärmeleitung vom Spiegelkörper 35 zur Tragestruktur 36 sowie für alternative Ausführungsformen der Wärmeleitungstreifen für den Wärmeleitungsabschnitt 37 und Details der thermischen Ankopplung des Abstandshalters 41 an den zentralen Haltekörper 40 sei auf die WO 2010/049076 A2 verwiesen.

- 10 Die Tragestruktur 36 ist als den Aktuatorstift 43 umgebende Hülse ausgestaltet. Die Tragestruktur 36 kann beispielsweise aus einem Silizium-Wafer hergestellt sein. Auf der Tragestruktur 36 ist das Array von Einzelspiegeln 27 nach Art der in der Fig. 11 gezeigten Einzelspiegel 27 angeordnet.
- 15 Im Folgenden werden Details des Wärmeleitungsabschnitts 37, insbesondere des Aufhängungselements 38 beschrieben. Bei der in den Fig. 11 und 12 dargestellten Ausführungsform ist der Wärmeleitungsabschnitt 37 aus insgesamt drei spiralförmig ausgeführten Wärmeleitungstreifen 56, 57 und 58 zusammengesetzt und stellt eine geschlitzte Membran dar. Der nähere
- 20 Aufbau der nach Art dreier ineinander verschachtelter Spiralfedern angeordneten Wärmeleitungstreifen 56 bis 58 ergibt sich aus der Schnittdarstellung der Fig. 12. Die Wärmeleitungstreifen 56 bis 58 sind radial um ein Zentrum 59 des Einzelspiegels 27 herumführend ausgeführt. In Bezug auf das Zentrum 59 an einem radial inneren Verbindungsabschnitt 60 des
- 25 Wärmeleitungsabschnitts 37 nach den Fig. 11 und 12 ist ein Verbindungsübergang 56i, 57i, 58i jeweils des Wärmeleitungstreifens 56, 57, 58 mit dem Spiegelkörper 35 angeordnet. Der radial innere Verbindungsabschnitt 60 des Wärmeleitungsabschnitts 37 stellt gleichzeitig den Haltekörper 40 dar. Die Verbindung des jeweiligen Wärmeleitungstreifens 56 bis 58 mit

dem Spiegelkörper 35 geschieht über den Verbindungsübergang 56i, 57i, 58i, den zentralen Haltekörper 40 und den Abstandshalter 41.

5 An einem radial äußeren Verbindungsabschnitt 61 ist ein Verbindungsübergang 56a, 57a, 58a des jeweiligen Wärmeleitungsstreifens 56, 57, 58 mit der Tragestruktur 36 angeordnet. Die Verbindung der Wärmeleitungsstreifen 56 bis 58 mit der Tragestruktur 36 erfolgt über die Verbindungsübergänge 56a, 57a, 58a, den äußeren Verbindungsabschnitt 61, der gleichzeitig den Haltering 39 darstellt, und die Hülse der Tragestruktur 36.

10

Die Wärmeleitungsstreifen 56 bis 58 verlaufen voneinander über Zwischenräume getrennt. Jeder der Wärmeleitungsstreifen 56 bis 58 verbindet unabhängig von den anderen Wärmeleitungsstreifen den Spiegelkörper 35 mit der Tragestruktur 36. Die Tragestruktur 36 kann, wie in der Fig. 12 angedeutet, nach außen hin rechteckig begrenzt sein.

15

Die Wärmeleitungsstreifen 56 bis 58 sind so angeordnet, dass sie auf einem Radius zwischen dem inneren Verbindungsabschnitt 60 und dem äußeren Verbindungsabschnitt 61 aufeinander folgen, wobei zwischen benachbarten
20 der Wärmeleitungsstreifen 56 bis 58 jeweils ein Zwischenraum vorliegt. Zwischen dem in der Fig. 12 in Bezug auf das Zentrum 59 in Drei-Uhr-Position angeordneten äußeren Verbindungsabschnitt 56a und dem in der Fig. 12 etwa in Fünf-Uhr-Position angeordneten inneren Verbindungsabschnitt 56i verläuft der Wärmeleitungsstreifen 56 in Umfangsrichtung um
25 das Zentrum 59 um etwa 420°. Der Wärmeleitungsstreifen 57 verläuft zwischen dem äußeren Verbindungsübergang 57a und dem inneren Verbindungsübergang 57i zwischen der Sieben-Uhr-Position und der Neun-Uhr-Position in der Fig. 12 ebenfalls in Umfangsrichtung im Uhrzeigersinn um etwa 420°. Der Wärmeleitungsstreifen 58 verläuft zwischen dem äußeren

- 26 -

Verbindungsübergang 58a und dem inneren Verbindungsübergang 58i zwischen der Elf-Uhr-Position und der Ein-Uhr-Position in der Fig. 12 ebenfalls in Umfangsrichtung um etwa 420° . Der Abstandshalter 41, der Aktuatorstift 43 sowie der Wärmeleitungsabschnitt 37 mit den Wärmeleitungsstreifen 56 bis 58, dem inneren Verbindungsabschnitt 60 und dem äußeren Verbindungsabschnitt 61 sind zusammen mit dem Spiegelkörper 35 aus monokristallinem Silizium gefertigt. Alternativ können die Wärmeleitungsstreifen 56 bis 58 inklusive der Verbindungsabschnitte 60, 61 auch aus polykristallinem Silizium mittels Mikrofabrikation gefertigt sein.

10

In der Hülse der Tragestruktur 36 sind insgesamt drei Elektroden 62₁, 62₂, 62₃ integriert, die in Umfangsrichtung um das Zentrum 59, jeweils etwa knapp 120° überstreckend, gegeneinander elektrisch isoliert angeordnet sind. Die Elektroden 62_i stellen Gegenelektroden zur zentralen Elektrode 44 auf dem als Elektrodenstift ausgebildeten Aktuatorstift 43 dar. Die äußeren Elektroden 62_i und die zentrale Elektrode 44 sind Bestandteil eines Aktuators 50 zur Verlagerung des Spiegelements 27. Die zentrale Elektrode 44 ist über den Abstandshalter 41 mit dem Spiegelkörper 35 des Spiegelements 27 verbunden. Der Aktuatorstift 43 kann als Hohlzylinder ausgeführt sein. Bei einer weiteren Ausführungsform des Einzelspiegels 27 können auch vier oder mehr Elektroden 62_i anstelle der drei Elektroden 62₁, 62₂, 62₃ vorhanden sein. Allgemein sind in der Tragestruktur 36 mindestens zwei Elektroden 62_i integriert. Es können auch vier oder mehr Elektroden 62_i in der Hülse der Tragestruktur 36 integriert sein, d. h. mit der Tragestruktur 36 verbunden sein. Die Elektroden 62_i sind insbesondere gleichmäßig um das Zentrum 59 herum angeordnet. Die Elektroden sind vorzugsweise gleichmäßig über den Umfang der Hülse verteilt angeordnet.

25

- 27 -

In der Fig. 11 rechts ist der Einzelspiegel 27 in einer gekippten Stellung gezeigt, in der die Gegenelektrode 62_i auf einem positiven Potenzial V₊ relativ zu einem negativen Potenzial V₋ der Elektrode 44 des Aktuatorstifts 43 geschaltet ist. Aufgrund dieser Potenzialdifferenz, V₊ minus V₋, ergibt
5 sich eine Kraft F_E, die das freie Ende des Aktuatorstifts 43 hin zur Gegenelektrode 64 zieht, was zu einer entsprechenden Verkipfung des Einzelspiegels 27 führt. Die federnde Membranaufhängung aus den drei Wärmeleitungsstreifen 56, 57, 58 sorgt dabei für eine nachgiebige und kontrollierte Verkipfung des Einzelspiegels 27. Zudem sorgt diese federnde Membranaufhängung für eine hohe Steifigkeit des Einzelspiegels 27 gegenüber
10 translatorischen Bewegungen in der Membranebene der federnden Membranaufhängung, das heißt insbesondere in Richtung senkrecht zur Flächennormalen 340, was auch als hohe in-plane-Steifigkeit bezeichnet ist. Diese hohe Steifigkeit gegenüber translatorischen Bewegungen in der
15 Membranebene unterdrückt eine unerwünschte translatorische Bewegung des Aktuatorstifts 43, also des Elektrodenstifts, in Richtung hin zu den Elektroden 62_j ganz oder weitgehend. Auf diese Weise ist eine unerwünschte Reduzierung eines möglichen Kippwinkelbereichs des Aktuatorstifts 43 und damit des Spiegelkörpers 35 vermieden.

20

Je nachdem, wie das relative Potenzial der Gegenelektroden 62_j zum Potenzial der Elektrode des Aktuatorstifts 43 gewählt ist, können die Einzelspiegel 27 um einen vorgegebenen Kippwinkel verkippt werden. Dabei sind nicht nur Kippwinkel möglich, die einer Neigung des Aktuatorstifts 43
25 genau zu einer der drei Gegenelektroden 62_j hin entsprechen, sondern, je nach einer vorgegebenen Potenzialkombination der Gegenelektroden 62_j, auch beliebige andere Kippwinkel-Orientierungen.

Anstelle eines Aktuatorstifts 43 mit rundem Querschnitt kann auch ein Aktuatorstift mit elliptischem Querschnitt gewählt werden. Die Halbachsen der Ellipse dieses Querschnitts sind dann so gewählt, dass ein Abstand zwischen der Elektrode des Aktuatorstifts und den Gegenelektroden 62_i entlang einer ersten Achse, in der ein größerer Kippwinkelbereich gewünscht ist, geringer ist als entlang einer zweiten, hierzu senkrechten zweiten Achse, längs der ein kleinerer Kippwinkelbereich gewünscht ist. Der größere Kippwinkelbereich kann 100 mrad oder 200 mrad und der kleinere Kippwinkelbereich kann 50 mrad betragen.

10

Bei der in Fig. 11 dargestellten Ausführungsform sind die in die Tragestruktur 36 integrierten, das heißt mit dieser verbundenen Elektroden 62₁, 62₂, 62₃ in z-Richtung gegen die mit dem Aktuatorstift 43 verbundene zentrale Elektrode 44 versetzt angeordnet. Dies führt dazu, dass bei Anlegen einer elektrischen Spannung zwischen den äußeren Elektroden 62₁, 62₂, 62₃ und der zentralen Elektrode 44 ein elektrisches Feld erzeugbar ist, welches im Bereich der zentralen Elektrode 44 einen Gradienten in z-Richtung der aufweist. Allgemein ist es möglich, ein elektrisches Feld zu erzeugen, welches eine über die Erstreckung der zentralen Elektrode 44 in z-Richtung variierende Feldstärke aufweist. Das elektrische Feld weist insbesondere eine derartige Verteilung der Feldstärke auf, das die über die Erstreckung der zentralen Elektrode 44 gemittelte Feldstärke eine Komponente in z-Richtung aufweist. Die gemittelte Feldstärke kann hierbei mithilfe eines Flächenintegrals des Feldstärken-Vektorfeldes über die Erstreckung der zentralen Elektrode 44 bestimmt werden. Ein derartiges Feld führt zu einer Kraft mit einer Komponente in z-Richtung, welche auf die zentrale Elektrode 44 und damit auf das Spiegelement 27 wirkt. Aufgrund der flexiblen Ausbildung des Aufhängungselements 38 ist das Spiegelement 27

20

25

somit durch Anlegen einer geeigneten Spannung an die äußeren Elektroden 62₁, 62₂, 62₃ und die zentrale Elektrode 44 linear in z-Richtung verlagerbar. Durch geeignete Ansteuerung der äußeren Elektroden 62₁, 62₂, 62₃ kann das Spiegelement 27 unabhängig von einer Verkipfung in z-

5 Richtung verlagert werden. In einer vorteilhaften Weiterbildung kann die Ansteuerung der Elektroden 62₁, 62₂, 62₃ und 44 Bestandteil einer Regeleinrichtung sein, welche außerdem mindestens einen, insbesondere mindestens mehrere Sensoren zur Erfassung der Position des Spiegelements 27, insbesondere dessen Position in z-Richtung und/oder dessen

10 Kippstellung, aufweist.

Die äußeren Elektroden 62₁, 62₂, 62₃ können alle dieselbe Länge in z-Richtung aufweisen. Sie können insbesondere auch dieselbe Länge wie die zentrale Elektrode 44 aufweisen, aber versetzt angeordnet sein.

15

Eine unerwünschte Verkipfung des Spiegelements 27 bei Anlegen einer Spannung an eine der Elektroden 62₁, 62₂, 62₃ in Bezug auf die zentrale Elektrode 44 kann durch Anlegen einer geeigneten Ausgleichsspannung an eine oder mehrere der übrigen äußeren Elektroden 62₁, 62₂, 62₃ erreicht

20 werden. Die Amplitude und Verteilung der an die übrigen Elektroden 62₁, 62₂, 62₃ anzulegende Ausgleichsspannung hängt von der Anzahl der äußeren Elektroden und deren Verteilung über die Tragestruktur 36 und um den Aktuatorstift 43 ab.

25 In den Fig. 13a und 13b ist eine weitere Ausführungsform dargestellt, bei welcher die Spiegelemente 27 relativ zur Tragestruktur 36 in z-Richtung linear verlagerbar und um eine quer zur Flächennormalen 340 orientierte Kippachse verkipfbar sind. Bei diesem Ausführungsbeispiel sind vier äu-

- ßere Elektroden 62_i in die Tragestruktur 36 integriert, von welchen in der Schnittdarstellung zwei einander gegenüberliegende Elektroden 62₁ und 62₃ dargestellt sind. Außerdem sind in den Figuren schematisch Spannungsquellen 45 und Zuleitungen 46 derselben zu den Elektroden 44, 62₁ und 62₃ dargestellt. Die Spannungsquellen 45 und die Zuleitungen 46 sind nur schematisch dargestellt. Sie sind in die Tragestruktur 36 integriert und mittels einer in den Figuren 13a und 13b nicht dargestellten Steuereinrichtung 153 in signalübertragender Weise verbunden.
- Bei diesem Ausführungsbeispiel ist die zentrale Elektrode 44 kürzer ausgebildet ist als die äußeren Elektroden 62_i. Hierdurch wird wiederum erreicht, dass sich durch Anlegen einer Spannung ein elektrisches Feld erzeugen lässt, dessen Feldlinien 48 in den Figuren schematisch angedeutet sind, welches eine über die Erstreckung der zentralen Elektrode 44 in z-Richtung variierende Feldstärke aufweist. Hierdurch lässt sich wiederum eine Kraft mit einer Komponente in z-Richtung auf die zentrale Elektrode 44 und somit über den Aktuatorstift 43 auf das Spiegelelement 27 ausüben.
- In den Fig. 14a und 14b ist eine weitere Ausführungsform des Aktuators 52 dargestellt. Bei dieser Ausführungsform sind die äußeren Elektroden 62_i zweiteilig ausgebildet. Sie weisen mit anderen Worten jeweils zwei separate Teilelektroden 49_i auf. Die Teilelektrode 49₁ und 49₂ sind jeweils in z-Richtung gegeneinander versetzt angeordnet. Sie sind insbesondere in z-Richtung hintereinander angeordnet. Sie sind unabhängig voneinander mit Spannung U_{y1} , U_{y2} , U_{-y1} , U_{-y2} beaufschlagbar. Die äußeren Elektroden 62_i können auch jeweils mehr als zwei Teilelektroden 49_i umfassen.

In den Fig. 15a und 15b ist ein weiteres Ausführungsbeispiel des Aktuators 52 dargestellt. Bei diesem Ausführungsbeispiel ist die separate Teilelektrode 51 quer, insbesondere senkrecht zur z-Richtung ausgerichtet. Mit einer derartigen, senkrecht zur z-Richtung ausgerichteten äußeren Teilelektrode
5 51 lässt sich besonders vorteilhaft eine lineare Verlagerung des Spiegелеlements 27 unabhängig von einer Verkipfung desselben steuern.

Der Einzelspiegel 27 ist also mittels des Aktuators 52 in Form eines elektromagnetisch arbeitenden Aktuators verlagerbar. Ein derartiger Aktuator
10 52 lässt sich in einem Batch-Prozess als mikroelektromechanisches System (micro-electro-mechanical system, MEMS) herstellen. Mit einem derartigen Aktuator 52 lässt sich eine Kraftdichte von 20 kPa erreichen. Die Kraftdichte ist definiert als das Verhältnis aus der Aktuatorkraft zu derjenigen Fläche des Aktuators 52, über die die Aktuatorkraft wirkt. Als Maß für
15 die an sich zu betrachtende Seitenfläche des Aktuators 52, über die die Aktuatorkraft wirkt, kann der Querschnitt des Aktuatorstifts 43 dienen. Die mittels des Aktuators 52 bewirkbare Verlagerung der Einzelspiegel 27 hängt einerseits von der mittels des Aktuators 52 erzeugbaren Kraft auf die Einzelspiegel 27 sowie andererseits von den Details deren Lagerung, ins-
20 besondere des Aufhängungselements 38, ab.

Für weitere Ausführungsformen des Aufhängungselements 38 und deren Details sei auf die WO 2010/049076 A2 verwiesen.

25 Eine Summe der Reflexionsflächen 34 auf den Spiegelkörpern 35 ist größer als das 0,5-fache einer von der Gesamt-Reflexionsfläche des Feldfacettenspiegels 26 belegten Gesamtfläche. Die Gesamtfläche ist dabei definiert als die Summe der Reflexionsflächen 34 zuzüglich der Flächenbelegung durch die Zwischenräume zwischen den Reflexionsflächen 34. Ein Ver-

hältnis der Summe der Reflexionsflächen der Spiegelkörper einerseits zu dieser Gesamtfläche wird auch als Integrationsdichte bezeichnet. Diese Integrationsdichte kann auch größer sein als 0,7, insbesondere größer als 0,9.

5

Mit Hilfe der Projektionsbelichtungsanlage 1 wird wenigstens ein Teil des Retikels 30 auf einen Bereich einer lichtempfindlichen Schicht auf dem Wafer zur lithografischen Herstellung eines mikro- bzw. nanostrukturierten Bauelements, insbesondere eines Halbleiterbauelements, z.B. eines Mikro-

10 chips abgebildet. Je nach Ausführung der Projektionsbelichtungsanlage 1 als Scanner oder als Stepper werden das Retikel 30 und der Wafer zeitlich synchronisiert in der y-Richtung kontinuierlich im Scannerbetrieb oder schrittweise im Stepperbetrieb verfahren.

15 Nachfolgend wird ein Verfahren zur Herstellung des Aktuators 50, insbesondere der Elektroden 44 und 62_i erläutert. Die einzelnen Verfahrensschritte sind schematisch in der Fig. 16 dargestellt.

In einem Bereitstellungsschritt 65 wird ein Ausgangssubstrat bereitgestellt.

20 Hierbei handelt es sich um einen monokristallinen Silizium-Wafer, dessen Dicke vorzugsweise zwischen 300 µm und 750 µm liegt. Die Dicke des Silizium-Wafers kann auch unterhalb oder oberhalb dieses Bereichs liegen. Als Vorderseite 66 (vgl. Fig. 11) des Ausgangssubstrats wird nachfolgend die Seite bezeichnet, an der später der Wärmeleitungsabschnitt 37 ange-

25 bracht wird. Die Gegenelektroden 62_i werden von einer der Vorderseite 66 gegenüberliegenden Substratrückseite 67 des Ausgangssubstrats her strukturiert.

In einem Ätzschritt 68 wird nun eine Basisstruktur von der Substratrückseite 67 in das Ausgangssubstrat, also in ein die spätere Tragestruktur 36 ergebendes Roh-Trägersubstrat geätzt. Es kann sich hierbei um die ring- oder hülsenförmige Tragestruktur 36 handeln. Die im Ätzschritt 68 geätzte Tragestruktur 36 ist an Trennstellen zwischen den Gegenelektroden 62_j unterbrochen. Der Ätzschritt 68 erfolgt mit Hilfe eines Standardverfahrens wie optischer Lithografie und Siliziumtiefenätzen (deep reactive ion etching, DRIE). Mit dem Ätzschritt 68 wird die Form der Gegenelektroden 62_j definiert und ein Negativ nach Art einer Gussform für die später zu schaffenden Gegenelektroden 62_j geätzt. Eine Äztiefe 69 definiert die Höhe der Gegenelektroden 62_j. Diese Äztiefe 69 kann geringer sein als die Dicke des Ausgangssubstrats. Bei einer nicht dargestellten Ausführung kann die Äztiefe auch genauso groß sein wie die Dicke des Ausgangssubstrats.

15 In einem Aufbringungsschritt 70 wird nun in Gussformen 71, die im Ätzschritt 68 geätzt wurden, zur elektrischen Isolierung der späteren Gegenelektroden 62_j auf das Ausgangssubstrat eine dielektrische Schicht aufgebracht. Bei der dielektrischen Schicht kann es sich um Siliziumdioxid handeln. Die Aufbringung kann mittels eines Standardverfahrens wie thermischer Oxidation oder CVD (Chemical Vapor Deposition) geschehen. Die Dicke der dielektrischen Schicht beträgt mehrere Mikrometer. Die dielektrische Schicht kann als Schicht aus dotiertem Siliziumoxid ausgeführt sein, wodurch eine Vorbereitung für eine spätere Dotierung der Gegenelektroden 62_j geschehen kann.

25

In einem Auffüllschritt 72 wird die mit der dielektrischen Schicht ausgekleidete Gussform 71 mit polykristallinem Silizium aufgefüllt. Hierbei kann ein LPCVD-(Low Pressure, Niederdruck, CVD)Verfahren zum Ein-

satz kommen. Das polykristalline Silizium ist dotiert und elektrisch leitfähig. Eine Dotierung des polykristallinen Siliziums kann direkt während des Auftragens oder nachträglich mittels Diffusion geschehen.

- 5 In einem Polierschritt 73, der durch ein CMP-(Chemical-Mechanical Polishing, chemisch-mechanisches Polieren)Verfahren realisiert sein kann, wird überschüssiges polykristallines Silizium, das während des Auffüllschritts 72 außerhalb der Gussformen 71 auf dem Ausgangssubstrat aufgewachsen ist, wegpoliert.

10

- In einem Strukturierschritt 74 wird nun auf der Vorderseite 66 des Ausgangssubstrats der Wärmeleitungsabschnitt 37 auf das Ausgangssubstrat aufgebracht. Dies kann mit Hilfe eines Dünnschichtverfahrens realisiert werden. Wie vorstehend erläutert, verbindet der Wärmeleitungsabschnitt 37
- 15 den Aktuatorstift 43, also die zentrale Elektrode 44, mit der Tragestruktur 36. Als Dünnschicht kann eine polykristalline Diamantschicht zum Einsatz kommen. Die polykristalline Diamantschicht kann mit Hilfe eines CVD-Verfahrens, insbesondere eines Niederdruck-CVD-Verfahrens, aufgebracht werden. Der Strukturierschritt 74 ist für das Gegenelektroden-
- 20 Herstellungsverfahren nicht zwingend, sondern dient der Vorbereitung der Anbringung der beweglichen zentralen Elektrode.

- In einem Anbringungsschritt 75 wird der Spiegelkörper 35 von der Vorderseite 66 her angebracht. Dies geschieht derart, dass die jeweiligen Spiegel-
- 25 körper 35 nach ihrer Vereinzelung jeweils im zentralen Bereich, also im Bereich des späteren zentralen Abstandshalters 41 mit dem Ausgangssubstrat verbunden sind. Der Anbringungsschritt 75 kann als Fusionsbond-Prozess gestaltet sein.

In einem weiteren Strukturierschritt 77 wird von der Rückseite 67 des Ausgangssubstrats her mit Hilfe optischer Lithografie und Tiefenätzverfahren die zentrale und vorzugsweise bewegliche Elektrode, also der Aktuatorstift 43, strukturiert. Dies geschieht durch Freiätzen eines Zwischenraums 76
5 zwischen dem Aktuatorstift 43, insbesondere der zentralen Elektrode 44, und der Hülse der Tragestruktur 36. Hierbei wird das Ausgangssubstrat komplett durchgeätzt. Die zentrale Elektrode 44 ist anschließend nur noch über den Wärmeleitungsabschnitt 37, also über die vorher auf der Vorderseite 66 angebrachte Federaufhängung mit dem Ausgangssubstrat verbunden.
10 Die Oxidschicht, die im Aufbringungsschritt 70 aufgebracht wurde, wirkt während dieses weiteren Strukturierschritts 77 als seitlicher Ätzstopp und schützt die im Auffüllschritt 72 für die Gegenelektroden 62_j vorbereiteten Elemente aus polykristallinem Silizium.

15 Erfindungsgemäß ist vorgesehen, im Strukturierschritt 77 den Aktuatorstift 43, insbesondere die zentrale Elektrode 44 zu verkürzen. Sie kann hierzu von der Rückseite 67 des Ausgangssubstrats her weggeätzt werden.

In einem Freilegungsschritt 78 wird nun die freigelegte Oxidschicht auf
20 einer Innenseite 79 der Gegenelektroden 62_j weggeätzt. Dieser Freilegungsschritt 78 kann auch weggelassen werden.

Der so vorbereitete Mikrospiegelaktuator kann in einem Anbindungsschritt 80 elektrisch und mechanisch an ein weiteres Substrat angebunden werden. Dies kann über ein Flip-Chip-Verfahren geschehen, über das die hergestellten Elektrodenanordnungen auf einen integrierten Schaltkreis (ASIC) ge-
25 bondet werden. Dies geschieht von der Substratrückseite 67 her. Hierbei werden die Gegenelektroden 62_j elektrisch mit entsprechenden Schaltkreisen auf dem integrierten Schaltkreis verbunden. Eine derartige Konfigura-

tion erlaubt eine integrierte Ansteuerung der Gegenelektroden 62_i und damit eine entsprechende Kontrolle der Kippspiegel des jeweiligen Einzelspiegels 27.

- 5 Die mit diesem Verfahren hergestellten Gegenelektroden 62_i sind in die Tragestruktur 36 integriert, sind insbesondere nicht mechanisch vom Ausgangssubstrat getrennt, sondern mit der Tragestruktur 36 verbunden. Die Tragestruktur 36 ist somit auch nach der Integration der Gegenelektroden 62_i eine monolithische Einheit, die genügend Stabilität für weitere Prozess-
- 10 schritte, insbesondere für die Verbindung im Anbindungsschritt 80 gewährleistet.

- Beim Anbindungsschritt 80 können die Gegenelektroden 62_i von der Rückseite 67 her über das Flip-Chip-Verfahren in einem Kontaktierungsschritt
- 15 81 direkt, also von einer in der Fig. 11 vertikal und senkrecht zur Reflexionsfläche 34 in der Neutralstellung verlaufenden Richtung her, kontaktiert werden. Ein Kontaktieren von einer beispielsweise in der Fig. 11 horizontal verlaufenden Richtung her ist nicht erforderlich.

- 20 Zusammengefasst umfasst das Verfahren zur Herstellung des optischen Bauelements 52 die folgenden Schritte: Bereitstellen eines Substrats zur Herstellung der Tragestruktur 36 für die Spiegelemente 27 und Strukturieren des Substrats mittels eines Ätzverfahrens sowie Abscheiden von Kontaktstrukturen auf dem Substrat zur Herstellung der Elektroden 44 und 62_i.
- 25 Erfindungsgemäß ist hierbei vorgesehen, die im fertigen Bauelement 52 als zentrale Elektroden 44 dienenden Strukturen selektiv durch ein Ätzverfahren zu verkürzen. Außerdem wird ein vorprozessierter Spiegel-Array-Waferstack bereitgestellt und mit dem Substrat zusammengefügt.

Für Details der Vorprozessierung des Spiegel-Array-Waferstacks sowie der Strukturierung des Substrats sei auf die vorhergehende Beschreibung sowie auf die WO 2010/049076 A2 und die DE 10 2011 006 100.2 verwiesen.

5

Für weitere Details der Herstellung des optischen Bauelements, insbesondere der Spiegelelemente 27, insbesondere Details eines Verfahrens zur Herstellung der Reflexionsfläche 34 mit extrem geringer Rauigkeit, sei auf die WO 2010/049076 A2 verwiesen.

10

Fig. 17 zeigt am Beispiel des Feldfacettenspiegels 13 das optische Bauelement 52 mit zeilen- und spaltenweise, also nach Art eines Arrays angeordneten Einzelspiegeln 27 schematisch im Querschnitt senkrecht zu einer gesamten Spiegel-Reflexionsfläche, zu der sich die Reflexionsflächen 34 der Einzelspiegel 27 ergänzen. Komponenten und Funktionen, die denjenigen entsprechen, die vorstehend unter Bezugnahme auf die Fig. 1 bis 16 bereits erläutert wurden, tragen die gleichen Bezugsziffern und werden nicht nochmals im Einzelnen diskutiert.

15

Die nach Art eines Arrays angeordneten Einzelspiegel 27 sind in der Fig. 17 schematisch zu einer Spiegelplatte 97 zusammengefasst. Über wärmeleitfähige Spiegelplatten-Fixierstifte 98, von denen in der Fig. 24 lediglich einer dargestellt ist, ist die Spiegelplatte 97 an einen Keramikträger 99 fixiert, der gleichzeitig die Funktion einer Wärmesenke hat, in den also beispielsweise durch Restabsorption oder über elektrische Leistung eingebrachte Wärme von der Spiegelplatte 97 weg abgeführt wird.

20

Der Keramikträger 99 ist Teil einer Verlagerungs-Ansteuerplatine 100, die auf der den Reflexionsflächen 34 gegenüberliegenden Seite der Spiegel-

platte 97, also der Einzelspiegel 27, angeordnet ist. Auf der Wärmesenke 99 der Ansteuerplatine 100 ist auf der der Spiegelplatte 97 zugewandten Seite zunächst eine Schicht eines Keramiksubstrats 101 aufgetragen. Das Keramiksubstrat 101 kann alternativ auch aus einem Siliziummaterial gefertigt sein. Auf dem Keramiksubstrat 101 sind integrierte elektronische Verlagerungsschaltungen (ASICs) 103 angeordnet. Jedem der verlagerbaren Einzelspiegel 27 des Feldfacettenspiegels 13 ist einer der ASICs 103 räumlich zugeordnet. Jeder ASIC 103 ist dabei einer Gruppe von Einzelspiegeln 27, nämlich jeweils genau vier Einzelspiegel 27, zugeordnet, wie nachfolgend noch beschrieben wird. Das Keramiksubstrat 101 ist an der Wärmesenke 99 über eine Mehrzahl von federnden Substrat-Fixierstiften 104 befestigt.

Über eine Anschlussklemme 105 ist die Ansteuerplatine 100 mit einer zentralen Steuereinrichtung 153 verbunden, die in der Fig. 17 nur schematisch dargestellt ist. Mit der Anschlussklemme 105 ist auch eine Masseleitung 106 der Ansteuerplatine 100 verbunden.

Fig. 18 zeigt ein Ansteuerungsschema für ein optisches Bauelement nach Art beispielsweise des Facettenspiegels 13, die in mehrere Teil-Einzelspiegelarrays aus jeweils zeilen- und spaltenweise angeordneten Einzelspiegeln 27 unterteilt ist.

Im Ansteuerschema nach Fig. 18 sind Hauptsteuerleitungen, Datenleitungen, eine Reset-Leitung und eine serielle Taktgeberleitung zu einem seriellen Datenbus 151 zusammengefasst. Über Bus-Schnittstellen 152 stehen die Teil-Einzelspiegelarrays 150 über den Datenbus 151 mit einer zentralen Steuereinrichtung 153 in Signalverbindung. Bei der zentralen Steuereinrichtung 153 kann es sich um einen Mikrocontroller oder um einen pro-

grammierbaren integrierten Schaltkreis, (Field Programmable Gate Array) oder um einen speziellen programmierbaren Logikbaustein (Programmable Logic Device, PLD) handeln. Über eine bidirektionale Signalleitung 154 steht die zentrale Steuereinrichtung 153 mit einem Zielapplikationsinter-
5 face 155 in Signalverbindung. Hierüber wird die Projektionsbelichtungsanlage 1 gesteuert und hierüber können die jeweiligen Beleuchtungssettings vorgegeben werden. Das Zielapplikationsinterface 155 hat ein Signalmodul 156 und ein Versorgungsmodul 157. Das Signalmodul 156 steht mit der Signalleitung 154 in Verbindung. Das Versorgungsmodul 157 des Zielap-
10 plikationsinterface 155 steht über eine Versorgungsleitung 158 mit einer zentralen Versorgungseinrichtung 159 in Verbindung, die in die zentrale Steuereinrichtung 153 integriert ist. Die zentrale Versorgungseinrichtung 159 steht über Versorgungsleitungen 160 mit Versorgungsschnittstellen 161 der Teil-Einzelspiegelarrays 150 in Verbindung.

15

Für Details der Ansteuerung des optischen Bauelements durch Vorgabe von individuellen Positionen der Einzelspiegel 27 desselben sei auf die WO 2010/049076 A2 verwiesen. Im Gegensatz zur Ansteuerung des optischen Bauelements 52 gemäß der WO 2010/049076 A2 ist erfindungsgemäß vor-
20 gesehen, zusätzlich zur Verschwenkposition, d. h. dem Kippwinkel, der Einzelspiegel 27 deren lineare Position in Richtung der Flächennormalen 340 vorzugeben. Mit anderen Worten ist vorgesehen, zur Einstellung eines Beleuchtungssettings mit einer vorgegebenen Winkel- und Phasen-Verteilung zur Beleuchtung des Objektfeldes 5 jeweils den Kippwinkel und
25 die Spiegelhöhe der Spiegelemente 27 mittels der Steuereinrichtung 153 einzustellen.

Im Folgenden werden unter Bezugnahme auf die Fig. 19 bis 22 weitere Anwendungsmöglichkeiten des optischen Bauelements 52 beschrieben.

Allgemein ist das Bauelement 52 Bestandteil einer Strahlführungsoptik insbesondere für ein Vielstrahlssystem. Mittels des optischen Bauelements 52 kann eine Mehrzahl von Strahlen oder Strahlenbündeln unabhängig voneinander geführt, insbesondere unabhängig voneinander auf eine Oberfläche 126 fokussiert werden. Hierbei ist insbesondere die Fokusslänge, d. h. die Brennweite, die Lage des Fokus auf der Oberfläche 126 oder in der Probe und die Intensitätsverteilung im Bereich des Fokus jedes der Strahlen durch Verlagerung der Spiegelemente 27 beeinflussbar. Gemäß dem in Fig. 19 dargestellten Ausführungsbeispiel ist das Bauelement 52 Bestandteil eines als Scanoptik 125 ausgebildeten optischen Systems. Hierbei handelt es sich um ein System, insbesondere ein Vielstrahlssystem, zur Bearbeitung und/oder Untersuchung einer Oberfläche 126. Bei einer Oberfläche 126 kann es sich insbesondere um eine gekrümmte Oberfläche 126 handeln. Bei dem optischen Vielstrahlssystem 125 handelt es sich insbesondere um eine Ladermaterialbearbeitungsanlage, ein System zur Lasermarkierung, ein System zur aufbauenden Herstellung von Strukturen, z. B. durch Laser-Sintern oder um ein System zur Laserbehandlung, insbesondere für medizinische Zwecke. Es kann sich auch um ein System zur dreidimensionalen Bildaufnahme, insbesondere zur dreidimensionalen Erfassung der topografischen Struktur einer Oberfläche handeln, Es kann sich auch um ein System zur dreidimensionalen Bildaufnahme mit lokaler Photoanregung handeln. Bei diesem auch als Photomanipulation bezeichneten Verfahren kann es vorteilhaft sein, mit einem Vielstrahlssystem an mehreren Stellen gleichzeitig die Probe mit Licht anzuregen. Die Bildaufnahme erfasst dann die Reaktion der Probe auf diese simultane Anregung. Eine weitere Anwendung nutzt die Einstellbarkeit des Vielstrahlsystems zur flexiblen strukturierten Beleuchtung. Hier wird ein Intensitätsgitter in der Probe erzeugt, das durch Berechnung von Bildern mit unterschiedlichen Gitterpositionen und -orientierungen eine Auflösungserhöhung erlaubt. Eine andere

Anwendung dieser Intensitätsgitter in der Probe ist eine quasi-konfokale Verringerung der Fokustiefe in einem Weitfeldmikroskop. Auch hier werden Bilder mit unterschiedlichen Gitterpositionen miteinander verrechnet. Die Scanoptik 125 umfasst ein Beleuchtungssystem 162 mit einer Strahlungsquelle 163. Als Strahlungsquelle dient insbesondere ein Laser. Die Strahlungsquelle 163 kann ein- oder mehrkanalig ausgebildet sein. Das Beleuchtungssystem 162 kann weitere optische Komponenten umfassen.

Die Laserstrahlung 127 wird mittels einer Fokussierlinse 128 über einen verkipptbar gelagerten Spiegel 129 zum optischen Bauelement 52 und von dort zur zu bearbeitenden Oberfläche 126 geführt. Der verkipptbar gelagerte Spiegel 129 und das optische Bauelement 52 sind Bestandteile einer Strahlungsoptik 130.

Der Spiegel 129 ist im Strahlengang zwischen der Strahlungsquelle 163 und dem optischen Bauelement 52 angeordnet.

Der Spiegel 129 ist um eine Kippachse 131 verkipptbar gelagert. Die Kippachse 131 verläuft in der Fig. 19 senkrecht zur Zeichenebene, was in der Fig. 19 durch zwei alternative Stellungen des Spiegels 129 verdeutlicht ist. Der Spiegel 129 kann auch um zwei Kippachsen, insbesondere zwei senkrecht aufeinander stehende Kippachsen 129 verkipptbar sein. Er weist somit mindestens einen, insbesondere mindestens zwei Kipp-Freiheitsgrade auf. Durch Verkipfung des Spiegels 129 können unterschiedliche Regionen 132_i auf dem optischen Bauelement 52 mit der Laserstrahlung 127 beaufschlagt werden. Exemplarisch sind in der Fig. 19 zwei Kippstellungen des Spiegels 129 mit dem entsprechenden Strahlengang zu zwei unterschiedlichen Regionen 132₁, 132₂ auf dem optischen Bauelement 52 dargestellt. Durch eine Verkipfung des Spiegels 129 und geeignete Verlagerung der

Spiegelemente 27 des Bauelements 52 lässt sich die Laserstrahlung 127 über die Oberfläche 126 verfahren. Hierbei kann durch eine Verlagerung der Spiegelemente 27 des Bauelements 52 erreicht werden, dass die Laserstrahlung 127 jeweils auf die Oberfläche 126 fokussiert ist.

5

Das optische System 125 weist mit anderen Worten eine verstellbare effektive Brennweite f_i auf. Die Brennweite kann insbesondere zwischen einem minimalen Wert $f_{\min}$ und einem maximalen Wert $f_{\max}$ verstellt werden. Die Differenz $f_{\max} - f_{\min}$ wird auch als Fokustiefe FT bezeichnet. Aufgrund der

- 10 Verstellbarkeit der Spiegelemente 27 des Bauelements 52 kann das optische System 125 prinzipiell eine große Fokustiefe FT aufweisen. Die Fokustiefe FT des optischen Systems 125 beträgt insbesondere mindestens 1 mm, insbesondere mindestens 1 cm, insbesondere mindestens 1 dm. Größere Fokustiefen FT, bis unendlich, sind ebenso möglich und je nach
- 15 Brennweite und Verstellbereich der Einzelspiegel 27 denkbar, z. B. wenn die Strahlen parallel den Spiegel verlassen.

Außerdem kann durch eine Verlagerung der Einzelspiegel 27 erreicht werden, dass ein Einfallswinkel der Laserstrahlung 127, insbesondere der

- 20 Hauptstrahlrichtung, an jedem Punkt der Oberfläche 126 in einem vorbestimmten Bereich liegt. Es kann insbesondere sichergestellt werden, dass der Einfallswinkel der Laserstrahlung 127, gemessen relativ zu einer Normalen 133 am jeweiligen Punkt der Oberfläche 126, höchstens 10° , insbesondere höchstens 5° , insbesondere höchstens 3° beträgt. Der Einfallswinkel kann insbesondere unabhängig von der lokalen Krümmung der Oberfläche 126 derart eingestellt werden, dass die Hauptstrahlrichtung im Wesentlichen senkrecht zur Oberfläche 126 ist. Das optische System 125 weist
- 25 allgemein eine verstellbare Hauptstrahlrichtung auf.

Darüber hinaus kann die Fokusform, d. h. die Intensitätsverteilung im Bereich des Fokus, auf einen für die Anwendung vorteilhaften Verlauf gezielt eingestellt werden. Dies wird nachfolgend noch genauer beschrieben.

- 5 Die Kippstellung des Spiegels 129 sowie die Kippstellungen und/oder Spiegelhöhen der Einzelspiegel 27 des Bauelements 52 sind mittels der nur schematisch dargestellten zentralen Steuereinrichtung 153 steuerbar.

- Gemäß der in Fig. 20 schematisch dargestellten Ausführungsform ist die
- 10 Strahlführungsoptik als multifokale Vielstrahl-Scanoptik 134 ausgebildet. Dies bedeutet, dass mehrere Strahlen 135_i gleichzeitig vom Beleuchtungssystem 162 zum optischen Bauelement 52 und von dort zur Oberfläche 126 geführt werden. Bei den Strahlen 135_i kann es sich auch um Strahlenbündel mit mehreren Teilstrahlen handeln. Jede der Strahlen 135_i wird auf eine
- 15 vorbestimmte der Regionen 132_i des optischen Bauelements 52 geführt und von dort auf die Oberfläche 126 fokussiert. Dabei können die Regionen 132_i mehrere oder auch nur einen Spiegel umfassen. Hierbei können unterschiedliche Strahlen 135_i in unterschiedliche, insbesondere in räumlich getrennte Foki 136_i auf der Oberfläche 126 fokussiert werden. Die Foki 136_1 ,
- 20 136_2 zweier Strahlungsbündel 135_1 und 135_2 gelten als unterschiedlich oder räumlich getrennt, wenn die Strahlung 10 des einen Fokus 136_1 nach Normierung der Intensität der jeweiligen Strahlungsbündel 135_1 , 135_2 zur Strahlungsintensität des anderen Fokus 136_2 im Bereich derselben optischen Ebene höchstens 1% beiträgt. Die Foki 136_i der unterschiedlichen
- 25 Strahlen oder Strahlen 135_i sind insbesondere unabhängig voneinander veränderbar. Durch Verlagerung der Einzelspiegel 27 kann insbesondere die effektive Brennweite f_i und/oder die Lage des jeweiligen Fokus 136_i auf der Oberfläche 126 und/oder dessen Ausdehnung verändert werden. Die Foki 136_i können räumlich voneinander getrennt sein. Sie können auch

paarweise überlappend, insbesondere paarweise vollständig überlappend sein.

5 Sobald kohärentes Licht über mehr als einen Spiegel auf einen gemeinsamen Fokus gelenkt wird, muss die Phase der Lichtwellen so aufeinander abgestimmt sein, dass eine phasenrichtige Überlagerung der Lichtwellen die gewünschte Lichtverteilung ergibt. Durch eine lineare Verlagerung, d. h. durch eine Einstellung der Spiegelhöhe, lässt sich die Phase der jeweils von dem Einzelspiegel 27 reflektierten Lichtwelle steuern.

10

Sind die Phasenlagenunterschiede der von verschiedenen Spiegeln 27 überlagerten Lichtwellen größer als der Einstellbereich der Spiegelhöhen, so können diese um ein ganzzahliges Vielfaches der Lichtwellenlänge reduziert werden. Dies geht jedoch nur bei ausreichender Kohärenzlänge und
15 ausreichend geringem Wellenspektrum des Nutzlichtes. Um diese Anforderungen zu reduzieren, ist es vorteilhaft, Brechkraft vom Mikrospiegelarray zu nehmen. Dies kann durch eine Fokussierlinse 128 oder Scanlinse im Strahlengang erreicht werden. Bei großen Scanwinkeln treten auch schnell große Phasenlagenunterschiede auf. Auch hier ist es vorteilhaft, die große
20 Scanbewegung eines Scanspiegels 129 zu realisieren. Das Mikrospiegelarray übernimmt dann die Feineinstellung. Auch auf diese Weise nimmt man Brechkraft vom Mikrolinsenarray.

Die Reihenfolge der drei Komponenten Mikrospiegelarray 52, Optik, insbesondere Fokussierlinse 128 bzw. Scanlinse, und Scanspiegel 129 im
25 Strahlengang kann dabei beliebig sein.

Mittels der Vielstrahl-Scanoptik 134 ist die Strahlung 10 von der Strahlungsquelle 163 in mindestens zwei, insbesondere mindestens drei, insbe-

sondere mindestens fünf, insbesondere mindestens zehn unterschiedliche Foki 136_i auf der Oberfläche 126 fokussierbar.

Durch Verlagerung der Spiegelemente 27 des Bauelements 52 können die
5 Strahlen 135_i unabhängig voneinander verändert werden. Hierdurch wird die Lichtverteilung auf der Oberfläche 126 verändert. Dabei ist es insbesondere möglich durch eine gezielte Anordnung der Foki 136_i der Strahlen 135_i auf der Oberfläche 126, insbesondere durch eine teilweise überlappende Anordnung der Foki 136_i eine vorgegebene Lichtverteilung zur Beleuch-
10 tung der Oberfläche 126 zu erreichen. Dabei ist – wie oben beschrieben – auf phasenrichtige Überlagerung der Lichtwellen zu achten. Bei einem erfindungsgemäßen Verfahren wird zunächst eine räumliche und/oder zeitliche Lichtverteilung zur Bearbeitung und/oder Untersuchung der Oberfläche 136 vorgegeben, welche dann durch eine gesteuerte Verlagerung der
15 Spiegelemente 27 erzeugt wird.

Im Folgenden werden exemplarisch mit der Scanoptik 134 erzeugbare Lichtverteilungen und deren mögliche Anwendungen beschrieben. Eine erste Lichtverteilung, welche durch Verlagerung der Spiegelemente 27
20 des Bauelements 52 erzeugbar ist, ist eine Airy-Verteilung. Hierbei wird ein beugungsbegrenzter Gesamtfokus 136 durch Interferenz geeigneter kohärenter Teilstrahlen 135_i erzeugt. Die Foki 136_i der Strahlen 135_i sind hierbei teilweise überlappend. Eine Airy-Verteilung ist insbesondere für eine Probe-Wechselwirkung mit hoher Ortsauflösung nützlich, beispielsweise für die Lasermaterialbearbeitung oder die Mikroskopie.
25

Eine weitere mit der Scanoptik 134 erzeugbare Verteilung ist die Kastenformverteilung („Top Hat“). Hierbei wird eine zumindest annähernd konstante Intensität in einer vorgegebenen, beliebig geformten Fläche erzeugt.

Die Intensität fällt randseitig schnell auf Null ab. Schnell bedeutet hier einen Intensitätsabfall, der vorzugsweise nicht langsamer als um den Faktor 2 vom Intensitätsabfall einer beugungsbegrenzten Fokusverteilung (Airy-Verteilung) abfällt.

5

Eine Kastenformverteilung eignet sich insbesondere für eine flächenhafte Probearbeitung mit vergleichsweise geringer Intensität, beispielsweise zur Laserbehandlung der Oberfläche 126 oder zur Bestrahlung ausgewählter Bereiche (region of interest) für die Photomanipulation in der Mikroskopie.

10

Eine weitere mit der Scanoptik 134 erzeugbare Lichtverteilung ist ein sogenannter Linienfokus. Bei dieser Verteilung wird eine zumindest weitestgehend konstante Intensität entlang einer vorgegebenen Linie erzeugt, welche am Rand schnell auf Null abfällt. Die Linie kann insbesondere parallel, senkrecht oder schräg zu einer Verfahrriichtung des Fokus 136 ausgerichtet sein. Diese Lichtverteilung eignet sich insbesondere für eine linienförmige Probearbeitung mit vergleichsweise hoher Intensität, insbesondere zur Laserkristallisation von Silizium.

15

20

Eine weitere mit der Scanoptik 134 erzeugbare Lichtverteilung ist eine flexibel einstellbare verlängerte Fokuszone. Bei dieser Verteilung wird eine zumindest weitgehend maximale Intensität im Fokus entlang einer Linie im Strahlengang erzeugt. Diese Lichtverteilung eignet sich insbesondere für das Laserstrahlschneiden von Materialien, die so dick sind, dass die „normale“ Fokusform entlang der Strahlenachse senkrechte Schneidflächen verhindern.

25

- Eine weitere mit der Scanoptik 134 erzeugbare Verteilung ist eine Doppelmaximum-Verteilung. Bei dieser Verteilung werden entlang einer Verfahrungsrichtung des Fokus 136 zwei zeitlich aufeinanderfolgende Maxima erzeugt. Diese sind an eine komplexe Prozessfolge angepasst. Beispielsweise können in einer Gasphasenabscheidung Moleküle nahe der Oberfläche 126 durch Strahlung im ersten Maximum gespalten werden und Strahlung im zweiten Maximum dazu verwendet werden, die Reaktion der Spaltprodukte mit der Oberfläche 126 zu unterstützen. Dabei kann es für eine optimale Prozessierung vorteilhaft sein, dass die beiden Foki aus Strahlung unterschiedlicher Wellenlänge erzeugt werden. Als weiteres Beispiel kann beim Laserstrahlschneiden das erste Maximum das Material aufschmelzen und ein zweites Maximum das geschmolzene Material aus dem Schneidschlitz auswerfen. Aus mehreren Foki zusammengesetzte Bearbeitungszonen bringen beim Laserstrahlschneiden erhebliche Vorteile bei Schnittgeschwindigkeit und -qualität. Derartige Vielstrahlbearbeitungszonen für die in der Praxis relevanten Bearbeitungsbedingungen, insbesondere wechselnde Schneidrichtung und unterschiedliche Geometrien, lassen sich mit dem erfindungsgemäßen Mikrospiegelarray 52 realisieren.
- Des weiteren kann mit dem erfindungsgemäßen Vielstrahlssystem ein Interferenzmuster generiert werden. Hierbei können insbesondere flexibel einstellbare Streifenmuster zur strukturierten Beleuchtung der Oberfläche oder Probe 126 erzeugt werden. Das Streifenmuster kann eine bestimmte Orientierung und/oder eine bestimmte Gitterperiode aufweisen. Diese Lichtverteilung ist – wie oben beschrieben – insbesondere für mikroskopische Anwendungen nützlich.

Weitere Lichtverteilungen sind ebenso möglich.

Die Lichtverteilung kann mithilfe der Steuereinrichtung 153 vorgegeben werden. Es handelt sich allgemein um eine eindimensionale, zweidimensionale, dreidimensionale oder vierdimensionale Lichtverteilung. Unter Letzterer sei eine zeitlich veränderbare dreidimensionale Lichtverteilung
5 verstanden. Als weitere Dimension kann die Lichtverteilung aus unterschiedlichen Wellenlängen zusammengesetzt sein. Es kann insbesondere vorgesehen sein, dass die Steuereinrichtung 153 eine bestimmte Auswahl an Lichtverteilungen für das Vielstrahlssystem zur Verfügung stellt. Diese Auswahl kann individuell erweiterbar sein.

10

Die Fokussierung der Strahlen 135_i erfolgt wiederum durch eine Verlagerung, insbesondere eine Verkippung und/oder lineare Verlagerung der Spiegelemente 27 des Bauelements 52. Die Fokussierung und/oder Ausrichtung der Strahlen 135_i können jeweils unabhängig voneinander erfolgen. Hierdurch ist es insbesondere möglich, nicht nur getrennte Foki 136_i
15 auf der Oberfläche 126 gleichzeitig zu beleuchten, sondern auch Bereiche der Oberfläche 126 mit einer gegebenen Lichtverteilung zu beleuchten.

Die lineare Verlagerung der Spiegelemente 27 erlaubt eine phasenrichtige
20 Überlagerung der von den Spiegelementen 27 reflektierten Teilstrahlen der Strahlen 135_i, um so die Fokusform gezielt einzustellen.

Bei der in Fig. 20 dargestellten Ausführungsform weist die Scanoptik 134 keine Fokussierlinse 128 und keinen Scanspiegel 129 auf. Es ist jedoch ebenso möglich, auch bei der Vielstrahl-Scanoptik 134 entsprechende Bauelemente vorzusehen. Hierbei kann insbesondere für jede der separaten
25 Strahlen 135_i eine separate Fokussierlinse 128_i vorgesehen sein. Es kann auch eine gemeinsame Fokussierlinse 128 für sämtliche Strahlen 135_i vorgesehen sein. Ebenso sind ein oder mehrere Ablenkspiegel und/oder ein oder mehrere Strahlteiler samt Fokussiereinrichtungen möglich.

Eine weitere Ausführungsform der Scanoptik 137 ist in Fig. 21 dargestellt. Diese Ausführungsform entspricht im Wesentlichen der in Fig. 19 dargestellten, auf deren Beschreibung verwiesen wird.

5

Zusätzlich zu den Bestandteilen der in Fig. 19 dargestellten Ausführungsform umfasst die Scanoptik 137 eine Autofokus-Einrichtung 138. Die Autofokus-Einrichtung 138 umfasst einen Detektor 139, eine Lochblende 140 und eine Fokussierlinse 141. Es handelt sich insbesondere um eine konfo-
10 kale Autofokus-Einrichtung 138. Mittels der Autofokus-Einrichtung 138 ist ein von der Oberfläche 126 reflektierter und/oder gestreuter Anteil 142 der Laserstrahlung 127 erfassbar. Der reflektierte und/oder gestreute Anteil 142 wird von der Oberfläche 126 über das optische Bauelement 52 und den Spiegel 129 zu einem Strahlteiler 143 geleitet und vom Strahlteiler 143 zur
15 Detektions-Einrichtung 139 umgelenkt. Die Detektions-Einrichtung erhält ein maximales Signal, wenn der Fokus 136_i auf der Oberfläche 126 zu liegen kommt.

Der Strahlteiler 143 ist im Strahlengang zwischen der Strahlungsquelle 3
20 und dem optischen Bauelement 52 angeordnet.

Mittels der Autofokus-Einrichtung 138, insbesondere mittels der Detektions-Einrichtung 139 derselben ist insbesondere eine Bestimmung der Entfernung zwischen dem optischen Bauelement 52 und der Oberfläche 126
25 möglich.

Die Autofokus-Einrichtung 138 ist in signalübertragender Weise mit der zentralen Steuereinrichtung 153 verbunden. Die Autofokus-Einrichtung 138 und die zentrale Steuereinrichtung 153 bilden insbesondere Bestandtei-

le einer Regelschleife zur Regelung der Positionen, insbesondere der Kippstellungen und/oder der Spiegelhöhen der Spiegelemente 27 des Bauelements 52. Mittels der Regelschleife ist es möglich, die effektive Brennweite f_i der Scanoptik 137 derart zu regeln, dass die Detektions-Einrichtung

5 139 stets ein maximales Signal erhält. Bei einer spekulär reflektierenden Oberfläche 126 ist das Signal am Detektor 139 maximal, wenn der Fokus in z-Richtung getroffen wird und gleichzeitig der Strahl auch senkrecht auf der Oberfläche 126 steht. Vorteilhaft ist hier die Auslegung des Detektors 130 als positionsempfindlicher Detektor (PSD; position sensitive detector)

10 zur Bestimmung des Strahlschwerpunktes. So kann Strahlrichtung und z-Lage des Fokus unabhängig voneinander bestimmt und geregelt werden. Auf diese Weise lässt sich vor der Bearbeitung und/oder Untersuchung die zu bearbeitende und/oder untersuchende Oberfläche 126 dreidimensional erfassen oder während der Bearbeitung und/oder Untersuchung der Fokus

15 136_i auf der Oberfläche 126 halten.

Wie in der Fig. 22 schematisch dargestellt ist, kann eine entsprechende Autofokus-Einrichtung 138 auch bei einer Vielstrahl-Scanoptik 134 entsprechend der in Fig. 20 dargestellten Ausführungsform vorgesehen sein. Im

20 Falle einer Vielstrahl-Scanoptik 134 umfasst die Autofokus-Einrichtung 138 jeweils für jede der Strahlen 135_i eine eigene Detektions-Einrichtung 139_i, eine eigene Lochblende 140_i und eine eigene Fokussierlinse 141_i. In den Fig. 20 und 22 sind zur Verdeutlichung des Konzepts jeweils zwei Strahlen 135₁, 135₂ dargestellt. Mittels der Vielstrahl-Scanoptik 134 sind

25 auch mehr als zwei Strahlen 135_i unabhängig voneinander auf die Oberfläche 126 fokussierbar. Die Anzahl der Strahlen 135_i kann insbesondere mindestens 3, insbesondere mindestens 10, insbesondere mindestens 100 betragen. Dies erhöht die Bearbeitungsgeschwindigkeit, setzt aber voraus,

dass Laserstrahlung mit ausreichend hoher Intensität bzw. Leistung zur Verfügung steht.

5 Zur Bearbeitung und/oder Untersuchung der Oberfläche 126 mit der Laserstrahlung 127 wird diese von der Strahlungsquelle 163 mittels der Strahlführungsoptik 134 zur Oberfläche 126 geführt. Hierbei wird zur Einstellung einer vorgegebenen Hauptstrahlrichtung und/oder Fokustiefe und/oder Lichtverteilung zumindest bei einem Teil der Spiegelemente 27 mittels der Steuereinrichtung 153 ein Kippwinkel und/oder eine Spiegelhöhe ein-
10 gestellt.

Im Folgenden werden unter Bezugnahme auf die Fig. 23 bis 26 weitere Ausführungsbeispiele von MEMS-basierten Vielstrahlsystemen 164 beschrieben. Die Vielstrahlsysteme 164 bieten gleichzeitig mehrere flexibel
15 einstellbare und/oder schnell im Raum veränderbare Foki 136_i, insbesondere mit maximaler Auflösung.

Das Vielstrahlsystem 164 findet vorteilhafterweise Anwendung für die Mikroskopie mit Vielstrahl-Laseranregung für die Fotomanipulation. Mit dem
20 Vielstrahlsystem 164 ist es insbesondere möglich, gleichzeitige Fotoanregung an mehreren Stellen vorzunehmen. Dies ist insbesondere für die Anregung von Nervenzellen, insbesondere einer Vielzahl von Nervenzellen in einem Netzwerk, zur Erforschung grundlegender neuronaler Prozesse von Vorteil. Es ist insbesondere auch möglich, einzelne Nervenzellen gleichzei-
25 tig oder in einer vorbestimmten zeitlichen Abfolge an unterschiedlichen Stellen anzuregen. Hierdurch wird es insbesondere möglich, die Integration neuronaler Inputs innerhalb einer einzelnen Zelle zu untersuchen.

Eine weitere Anwendung des Vielstrahlsystems 164 liegt in der Parallelbearbeitung in der Lasermaterialbearbeitung. Aufgrund der Parallelisierung wird eine schnellere Bearbeitungsgeschwindigkeit bei voller Flexibilität der Fokuspositionen ermöglicht.

5

Gemäß der in Fig. 23 dargestellten Ausführungsform ist das als MMA ausgebildete optische Bauelement 52 in einer zur Pupille konjugierten Ebene angeordnet. Die Spiegel-Elemente 27 sind in der Fig. 23 nur schematisch angedeutet. Für Details des Aufbaus des MMA sowie insbesondere der Anordnung und Verlagerbarkeit der Spiegel-Elemente 27 sei auf die Beschreibung der vorhergehenden Ausführungsbeispiele verwiesen.

10

Das MMA wird mit Beleuchtungsstrahlung 165 von einer Strahlungsquelle 166 beaufschlagt. Es wird insbesondere unter senkrechtem Einfall mit der Beleuchtungsstrahlung 165 beaufschlagt.

15

Für Details der Strahlungsquelle 166 und der Beleuchtungsstrahlung 165 wird wiederum auf die vorhergehende Beschreibung verwiesen. Als Strahlungsquelle 166 kann insbesondere ein Laser dienen. Die Strahlungsquelle 166 dient insbesondere der Erzeugung kohärenter Beleuchtungsstrahlung 165, insbesondere spektralkohärenter Beleuchtungsstrahlung 165. Die Beleuchtungsstrahlung 165 wird über einen Strahlteiler 167 eingekoppelt.

20

Bei der in Fig. 23 dargestellten Ausführungsform kann von jedem der Spiegel-Elemente 27 ein Fokuspunkt 136_i an einem beliebigen Punkt der Objektebene 6 erzeugt werden. Durch phasenrichtiges Überlagern der entsprechenden Strahlenbündel 135_i kann ein Fokuspunkt 136_i mit maximaler Auflösung erzeugt werden.

25

Beim Objektiv 168 kann es sich um ein katoptrisches, ein dioptrisches oder ein katadioptrisches Objektiv handeln.

Bei den in der Fig. 23 schematisch dargestellten drei Foki 136_i kann beispielsweise jedes dritte Spiegel-Element 27 des optischen Bauelements 52 zu einem der Foki 136_i beitragen. Selbstverständlich können auch mehrere, benachbart zueinander angeordnete Spiegel-Elemente 27 zur Fokussierung eines Strahlenbündels 135 beitragen. Prinzipiell kann die Anzahl der Spiegel-Elemente 27, welche zu einem der Foki 136_i beitragen, auch für unterschiedliche Foki 136_i unterschiedlich sein. Es ist beispielsweise auch möglich, unterschiedliche Foki 136_i mit unterschiedlicher Intensität zu beleuchten.

Die Anzahl der Foki 136_i ist höchstens so groß wie die Anzahl der Spiegel-Elemente 27 des optischen Bauelements 52. Sie liegt insbesondere im Bereich zwischen 1 und dieser Maximalzahl. Sie liegt je nach Anwendung vorzugsweise im Bereich von 2 bis 10000, insbesondere bei mindestens 3, insbesondere mindestens 5, insbesondere mindestens 10 und/oder höchstens 5000, insbesondere höchstens 2000, insbesondere höchstens 1000, insbesondere höchstens 500, insbesondere höchstens 200, insbesondere höchstens 100.

In Fig. 23a ist eine periodische Verteilung der Anordnung der Spiegel-Elemente 27 des optischen Bauelements 52 exemplarisch dargestellt. Eine derartige Verteilung kann allerdings dazu führen, dass die einzelnen Foki 136_i Nebenmaxima aufweisen, welche von der Periode der dem jeweiligen Fokus 136_i zugeordneten Spiegel-Elemente 27 abhängen. In einer bevorzugten Ausführungsform werden die Spiegel-Elemente 27 daher, wie exemplarisch in der Fig. 23b dargestellt ist, aperiodisch angeordnet. Es wird

insbesondere eine Verteilung der Spiegel-Elemente 27 gewählt, die möglichst wenig periodische Abstände der dem jeweiligen Fokus 136_i zugeordneten Spiegel-Elemente 27 hat. Vorzugsweise wird eine Verteilung gewählt, bei welcher die Nebenmaxima der Fourier-transformierten der Verteilung möglichst wenig ausgeprägt, das heißt stark verschmiert sind.

Wie in der Fig. 24 exemplarisch dargestellt ist, kann auch auf den Strahlteiler 167 verzichtet werden. Das Vielstrahlssystem 164 gemäß Fig. 24 entspricht ansonsten dem Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 23, auf dessen Beschreibung hiermit verwiesen wird.

Vorzugsweise sind die Spiegel-Elemente 27 sowohl in lateraler als auch in vertikaler Richtung relativ zu ihrer Reflexionsfläche verstellbar. Hierdurch wird eine phasenrichtige Überlagerung der Teilstrahlen ermöglicht. Vorzugsweise sind die Spiegel-Elemente 27 außerdem, wie vorhergehend beschrieben, verschwenkbar.

Für eine phasenrichtige Überlagerung der Teilstrahlen ist es ausreichend, wenn die Spiegelhöhe, das heißt die Position der Spiegel-Elemente 27, in Richtung senkrecht zu ihrer Reflexionsfläche 34 modulo $\lambda/2$ eingestellt wird.

Vorzugsweise wird eine spektral kohärente Beleuchtungsstrahlung 165 verwendet. Es kann insbesondere ein Laser als Strahlungsquelle 166 verwendet werden. Im Falle einer polychromatischen Strahlungsquelle kann zwischen der Strahlungsquelle 166 und dem optischen Bauelement 52 ein Spektralfilter vorgesehen sein.

Zwischen der Pupillenebene mit dem optischen Bauelement 52 und der Objektebene 6 durchläuft die Beleuchtungsstrahlung 165 eine Zwischenfokusebene 169.

- 5 Gemäß einer vorteilhaften, schematisch in Fig. 25 dargestellten Ausführungsform ist außerdem eine Raumfilterung in der Zwischenfokusebene 169 vorgesehen. Mittels einer derartigen Raumfilterung der Zwischenfokusebene 169 kann die Intensitätsverteilung in den Foki 136_i, insbesondere von dem aufgrund der als Gitter wirkenden Struktur des optischen Bauelements 52 gebeugten Licht bereinigt werden. Zur Raumfilterung ist im Bereich der Zwischenfokusebene 169 ein weiteres Multispiegel-Array 170 angeordnet. Das Multispiegel-Array 170 ist derart ausgelegt, dass nur die Einzelspiegel 171_i an einem zu einem der Foki 136_i konjugierten Ort die einfallende Beleuchtungsstrahlung 165 zum Objektiv 168 hin reflektieren (siehe Fig. 26). Die übrigen Einzelspiegel 172 werden derart verschwenkt, dass sie das einfallende Störlicht aus dem Strahlengang herauslenken, beispielsweise in eine in der Fig. nicht dargestellte Lichtfalle. Der Aufbau des Multispiegel-Arrays 170 kann insbesondere dem des optischen Bauelements 52 entsprechen. Die Einzelspiegel 171_i werden vorteilhaft so klein gewählt, dass das am nächsten liegende, vom optischen Bauelement 52 gebeugte Licht nicht mehr darauf fällt.

- Bei einer geänderten Ansteuerung der Spiegel-Elemente 27 des optischen Bauelements 52, welche zu einer Verschiebung der Foki 136_i und damit zu einer entsprechenden Verlagerung der konjugierten Bilder dieser Foki 136_i in der Zwischenfokusebene 169 führt, wird die Einstellung der Einzelspiegel 171_i, 172 des Multispiegel-Arrays 170 entsprechend angepasst. Das Vielstrahlensystem 164 kann weitere Bestandteile aufweisen, welche aus Gründen der Klarheit in den Fig. nicht dargestellt wurden. Beispielsweise

- kann das Vielstrahlssystem 164 eine Fourier-Optik umfassen. Die Fourier-Optik kann insbesondere im Bereich zwischen der Pupillenebene und der Zwischenfokusebene 169, insbesondere im Strahlengang zwischen dem optischen Bauelement 52 und dem Multispiegel-Array 170 angeordnet
- 5 sein. Außerdem kann je nach Größe und Kippwinkelbereich des optischen Bauelements 52 eine Anpassoptik vorgesehen sein. Außerdem kann neben dem Beleuchtungsstrahlengang ein weiterer Strahlengang vorgesehen sein, der z. B. zur Beobachtung der Objektebene 6 oder zur Detektion von Messgrößen, wie der von der Oberfläche 6 reflektierten Intensität, dienen.
- 10 Die beiden Strahlengänge können vorteilhaft über einen hier nicht gezeigten Strahlenteiler, der zwischen Objektebene 6 und dem Multispiegel-Array 52 bzw. 169 liegt, kombiniert werden.

- Das Vielstrahlssystem 164 ermöglicht insbesondere eine strukturierte Beleuchtung der Objektebene 6. Dies ist insbesondere bei mikroskopischen Anwendungen, insbesondere für die sogenannte „structured illumination microscopy (SIM)“, insbesondere gemäß Gustafsson und Sedat, vorteilhaft. Mittels des Vielstrahlssystems 164 ist es insbesondere möglich, eine strukturierte Beleuchtung ohne den Einsatz konventioneller Intensitäts- und/oder
- 20 Phasengitter zu erreichen. Das Vielstrahlssystem 164 ermöglicht insbesondere eine flexibel einstellbare und schnell umstellbare Beleuchtung. Außerdem kann eine verbesserte Sinusform im Vergleich zu konventionellen Gittern erreicht werden. Schließlich kann die Gitterperiode auf einfache Weise an das Objektiv angepasst werden sowie die Phasenlage des Gitters
- 25 zwischen einzelnen Aufnahmen lateral verschoben und/oder rotiert werden.

Patentansprüche

1. Strahlführungsoptik (4, 7; 130; 134; 137) für ein Vielstrahlssystem (1; 125) zur Bearbeitung und/oder Untersuchung einer Oberfläche (8; 126)
- 5 mit
- einem optischen Bauelement (52) zur Führung einer Mehrzahl von Strahlen (135_i) zu einer Oberfläche (6; 126) umfassend
 - eine Vielzahl von Spiegel-Elementen (27), welche jeweils einen Spiegelkörper (35) mit einer Reflexionsfläche (36) mit einer zentralen Flächennormalen (340) aufweisen, und
 - 10 -- eine Tragestruktur (36), welche mechanisch mit den Spiegel-Elementen (27) verbunden ist,
 - wobei zumindest ein Teil der Spiegel-Elemente (27) mittels ihnen jeweils zugeordneten elektromagnetischen Akutatoren (50) relativ zur Tragestruktur (36)
 - 15 --- in einer z-Richtung, welche parallel zur Flächennormalen (340) des jeweiligen Spiegel-Elements (27) in einer Mittelstellung verläuft, linear verlagerbar und
 - 20 --- aus der Mittelstellung um mindestens eine quer zur Flächennormalen (340) orientierte Kippachse verkippt ist, und
 - wobei mindestens zwei unterschiedliche Strahlen (135₁, 135₂) mittels der Spiegel-Elemente (27) in unterschiedliche Foki (136_i, 136₂) auf die Oberfläche (6; 126) fokussierbar sind.
- 25
2. Strahlführungsoptik (4, 7; 130; 134; 137) gemäß Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, dass** das optische Bauelement (52) als mikroelektromechanisches System (MEMS) mit einer Vielzahl von Mikrospiegeln (27) ausgebildet ist.

- 58 -

3. Optisches Vielstrahlsystem (1; 125; 137; 164) zur Bearbeitung und/oder Untersuchung einer Oberfläche (6; 126) umfassend
 - eine Strahlführungsoptik (4, 7; 130; 134; 137) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 2 und
- 5 - eine Strahlungsquelle (3; 163) zur Erzeugung von Beleuchtungsstrahlung (10; 127).

4. Optisches Vielstrahlsystem (1; 125; 164) gemäß Anspruch 3, **dadurch gekennzeichnet, dass** mittels der Strahlführungsoptik (4; 7; 130; 134; 10 137) ein einziger einfallender Strahl in mehrere Foki (136_i) fokussierbar ist.

5. Optisches Vielstrahlsystem (1; 125; 164) gemäß einem der Ansprüche 3 bis 4, **dadurch gekennzeichnet, dass** mittels der Strahlführungsoptik 15 (4; 7; 130; 134; 137) eine Mehrzahl einfallender Strahlen (135_i) unabhängig voneinander in einen oder mehrere Foki (136_i) fokussierbar ist.

6. Optisches Vielstrahlsystem (1; 125; 164) gemäß einem der Ansprüche 3 bis 5, **dadurch gekennzeichnet, dass** zur Beleuchtung der Oberflä- 20 che (6; 126) mit einer bestimmten Lichtverteilung die Beleuchtungsstrahlung (10; 127) von der Strahlungsquelle (3; 163) in teilweise überlappende Foki (136) fokussierbar ist.

7. Optisches Vielstrahlsystem (1; 125; 164) gemäß einem der Ansprüche 25 3 bis 6, **gekennzeichnet durch** eine Detektions-Einrichtung (139) zur konfokalen Bestimmung einer Entfernung zwischen dem optischen Bauelement (52) und der zu bearbeitenden Oberfläche (6; 126).

8. Optisches Vielstrahlsystem (1; 125; 164) gemäß einem der Ansprüche 3 bis 7, **dadurch gekennzeichnet, dass** im Strahlengang zwischen der Strahlungsquelle (163) und dem optischen Bauelement (52) mindestens ein Strahlteiler (143) angeordnet ist.

5

9. Optisches Vielstrahlsystem (164) gemäß einem der Ansprüche 3 bis 7, **dadurch gekennzeichnet, dass** im Strahlengang zwischen dem optischen Bauelement (52) und der Oberfläche (6; 126) ein Raumfilter (170) angeordnet ist.

10

10. Optisches Vielstrahlsystem (164) gemäß Anspruch 9, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Raumfilter als Multispiegel-Array (170) ausgebildet ist.

- 15 11. Verfahren zur Bearbeitung und/oder Untersuchung einer Oberfläche mit Strahlung (10; 127) umfassend die folgenden Schritte:

- a. Bereitstellen eines optischen Vielstrahlensystems (1; 125) gemäß einem der Ansprüche 3 bis 10,
- b. Erzeugen von Strahlung (10; 127) mittels der Strahlungsquelle (3; 163),
- 20 c. Führen mindestens eines Teils der Strahlung (10; 127) von der Strahlungsquelle (3; 163) zu einer Oberfläche mittels der Strahlungsoptik (4, 7; 130; 134; 137) ,
- d. wobei zur Einstellung eines vorgegebenen Beleuchtungssettings,
- 25 einer vorgegebenen Hauptstrahlrichtung und/oder Brennweite und/oder Fokusform und/oder Intensitätsverteilung einer Mehrzahl von Strahlen (135_i) zumindest bei einem Teil der Spiegel-Elemente (27) mittels einer Steuereinrichtung (153) ein Kippwinkel und/oder eine Spiegelhöhe eingestellt wird.

- 60 -

12. Verfahren gemäß Anspruch 11, **dadurch gekennzeichnet, dass** zu-
nächst eine räumliche und/oder zeitliche Lichtverteilung zur Bear-
beitung und/oder Untersuchung der Oberfläche (126) vorgegeben
5 wird, welche dann durch eine gesteuerte Verlagerung der Spiegel-
elemente (27) erzeugt wird.
13. Verfahren gemäß Anspruch 11 bis 12, **dadurch gekennzeichnet,**
dass eine räumliche und/oder zeitliche Lichtverteilung zur Bear-
10 beitung und/oder Untersuchung der Oberfläche (126) gleichzeitig
mit unterschiedlichen Nutzwellenlängen erfolgt.
14. Verwendung eines optischen Vielstrahlsystems (1; 125; 137; 164)
gemäß einem der Ansprüche 3 bis 10 zur Lasermaterialbearbei-
15 tung.
15. Verwendung eines optischen Vielstrahlsystems (1; 125; 137; 164)
gemäß einem der Ansprüche 3 bis 10 zur Mikroskopie mit Viel-
strahl-Fotoanregung.

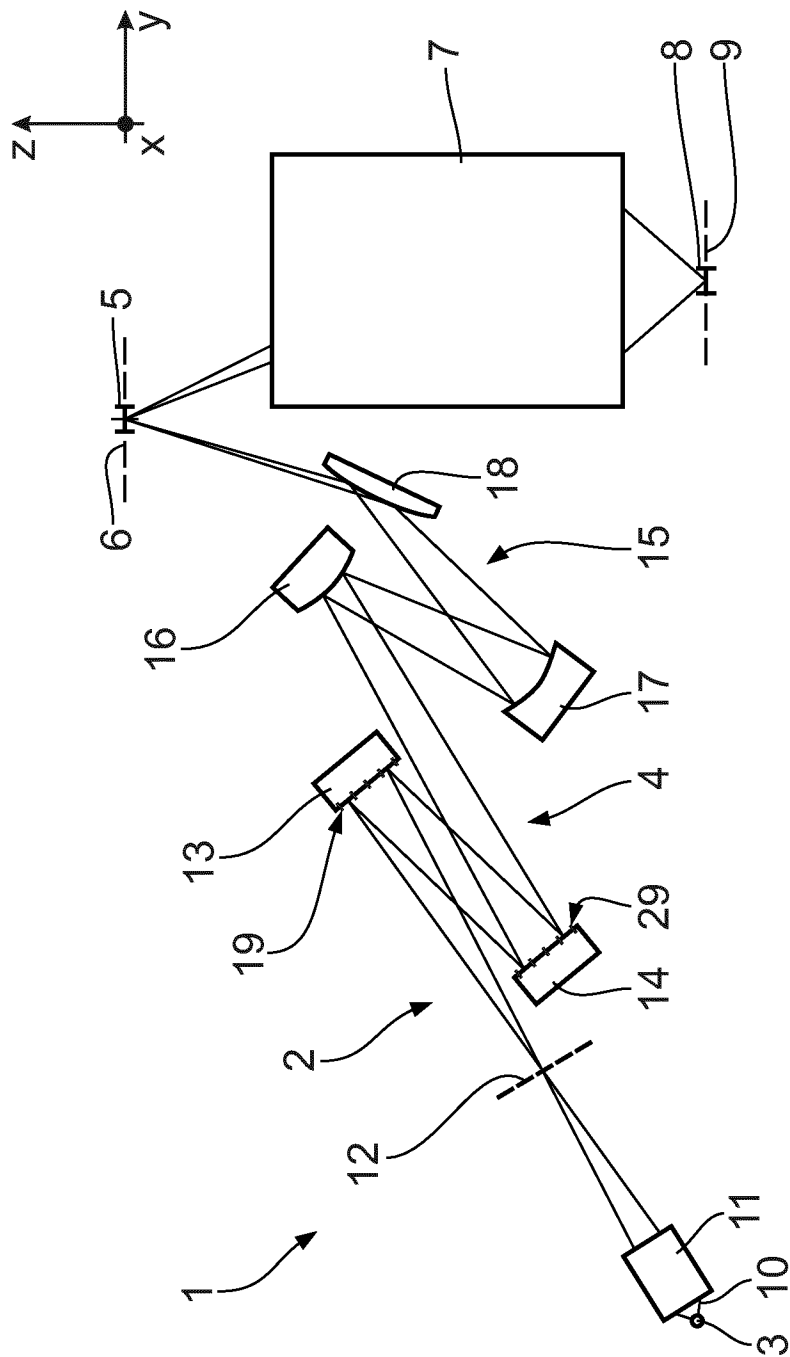
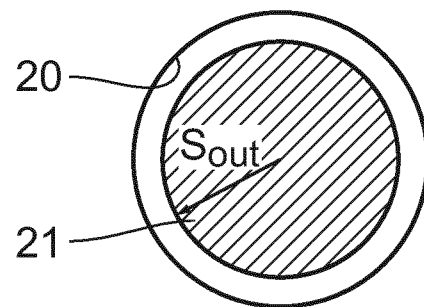


Fig. 1

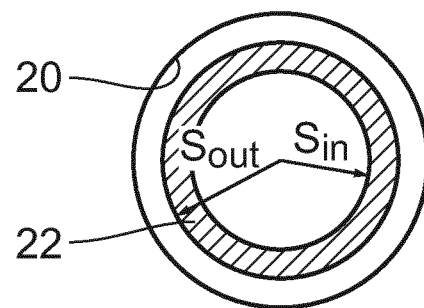
2/21



$$S_{out} = 0.8$$

$$S_{in} = 0.0$$

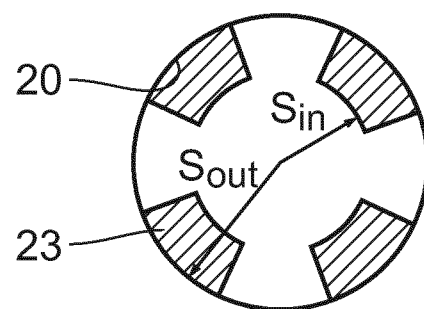
Fig. 2



$$S_{out} = 0.8$$

$$S_{in} = 0.6$$

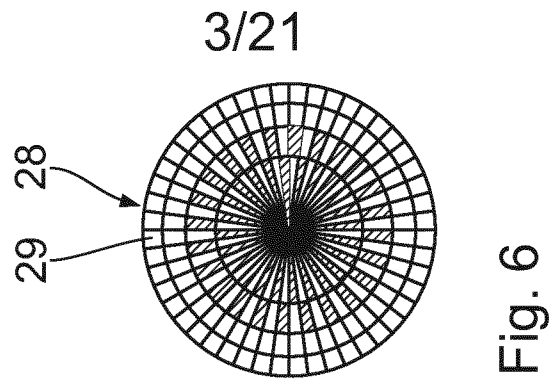
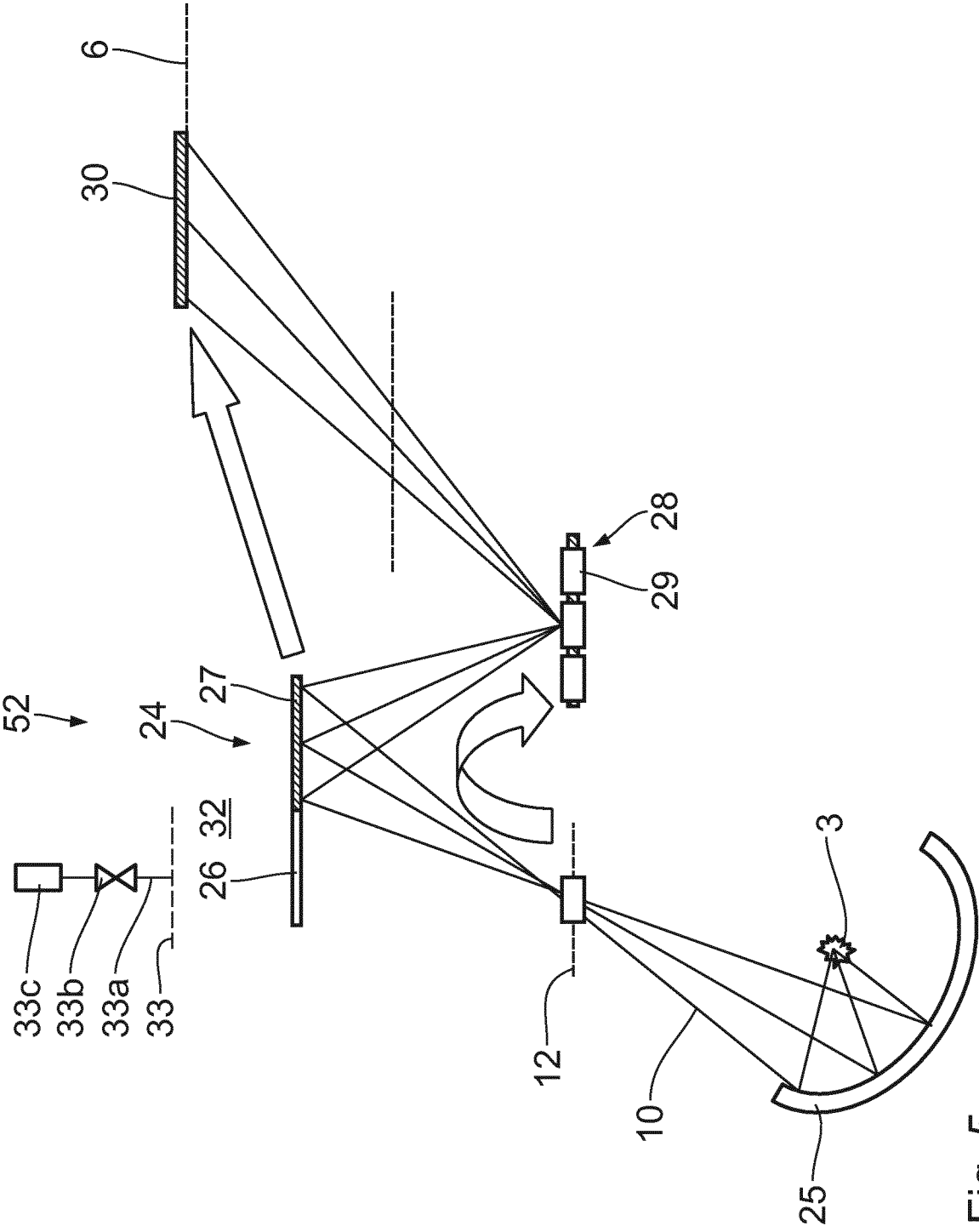
Fig. 3

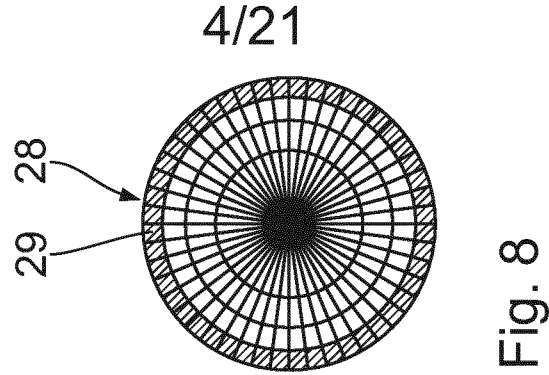
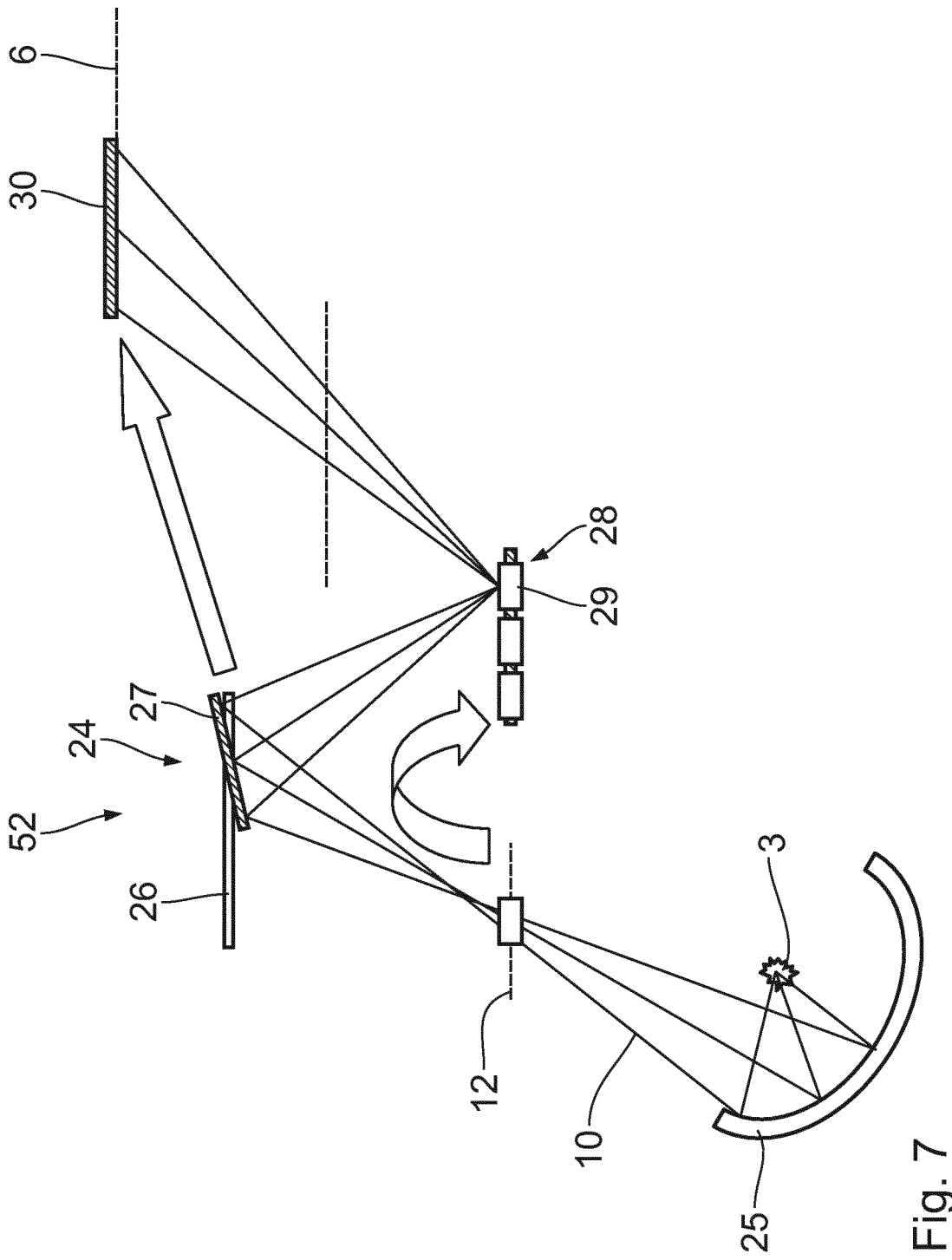


$$S_{out} = 1.0$$

$$S_{in} = 0.6$$

Fig. 4





4/21

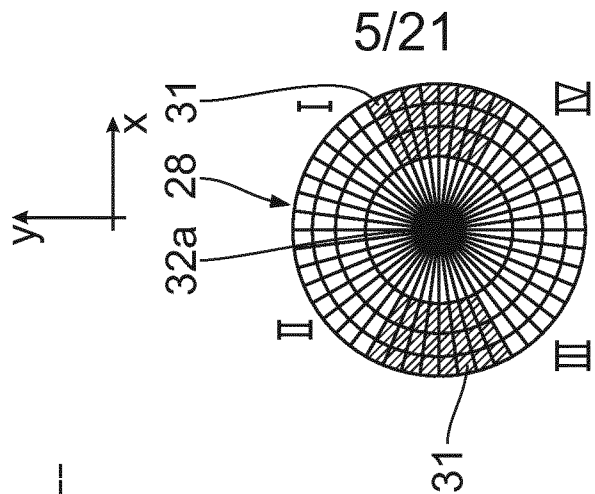
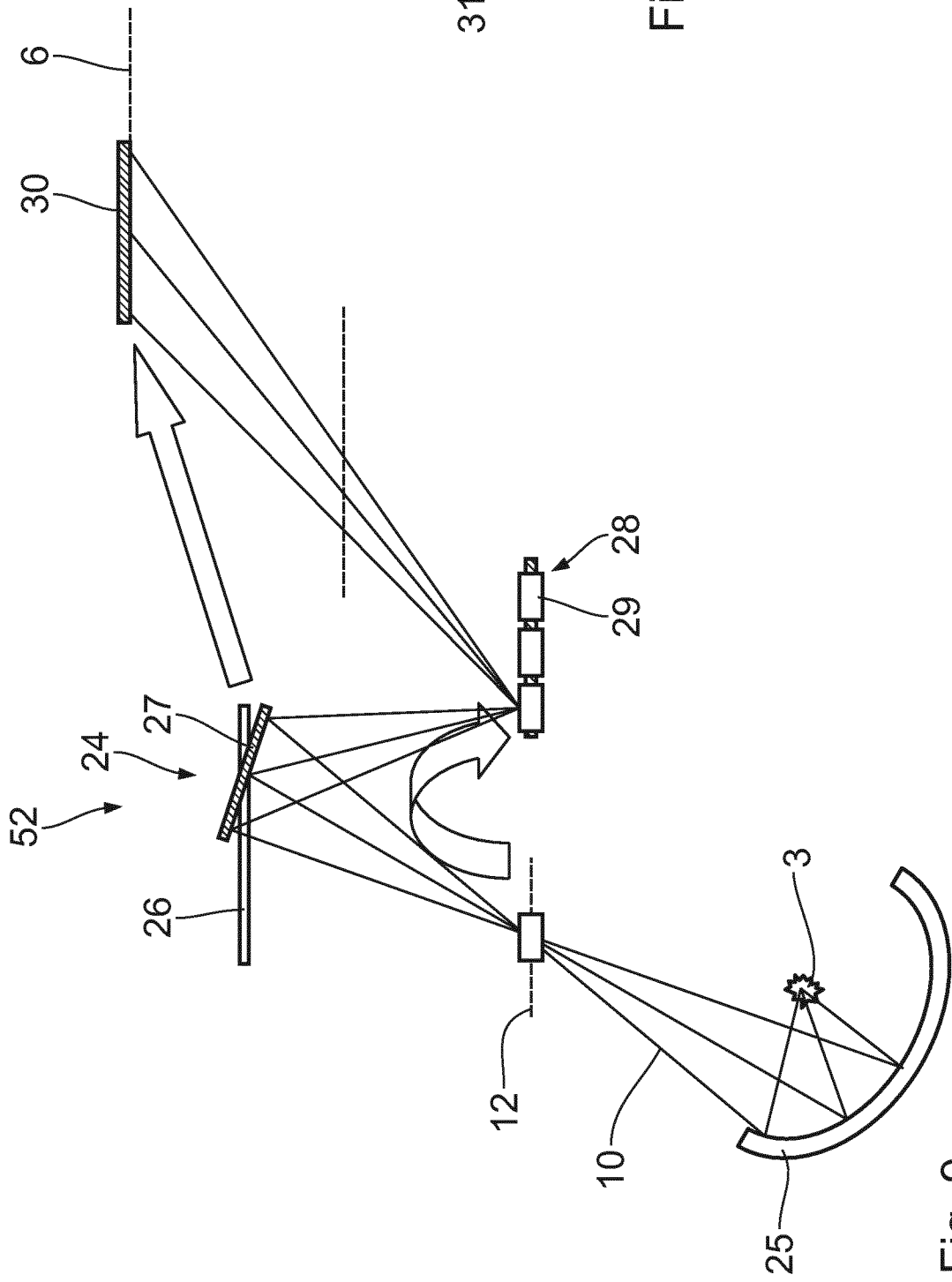


Fig. 10

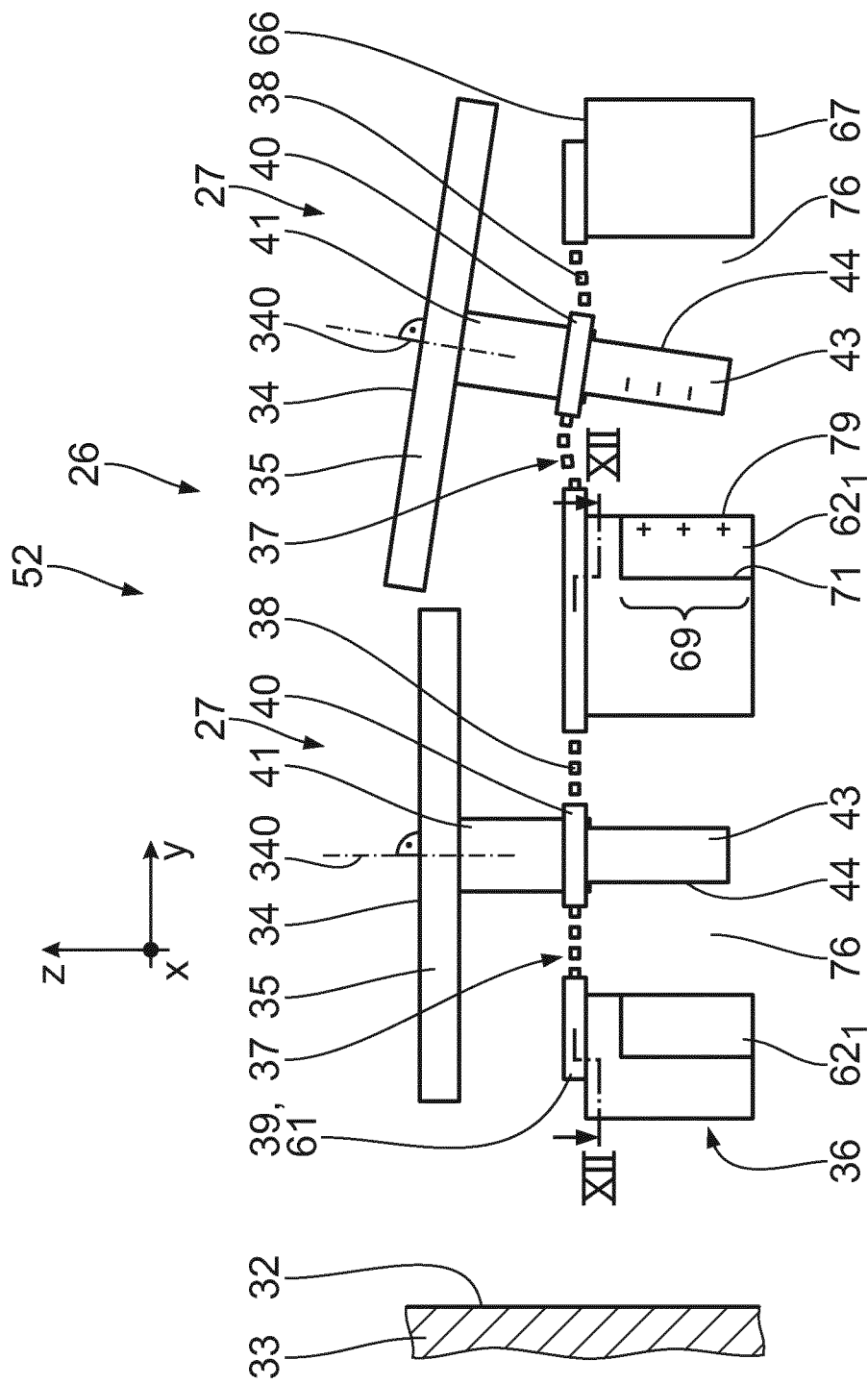


Fig. 11

7/21

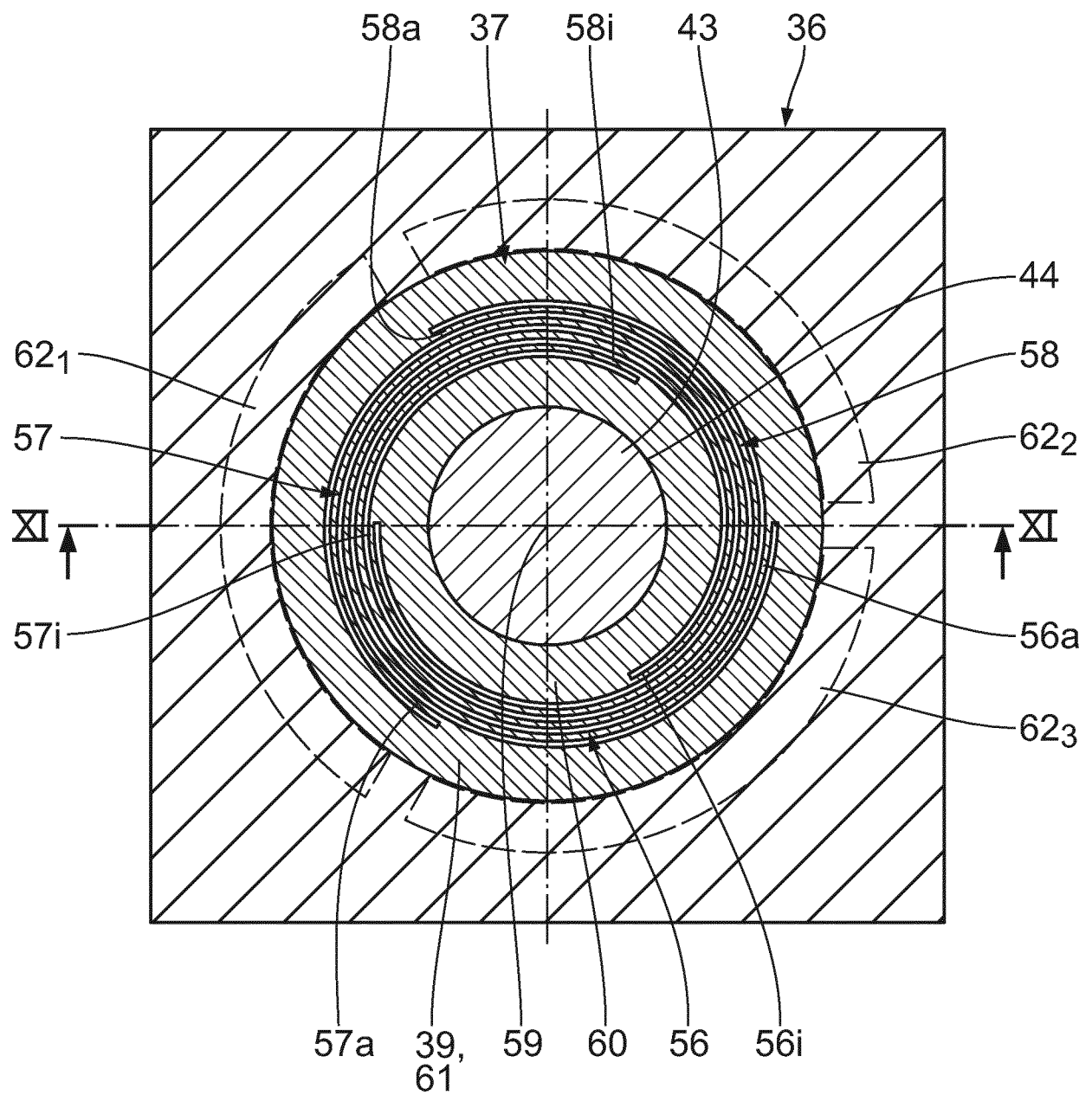


Fig. 12

8/21

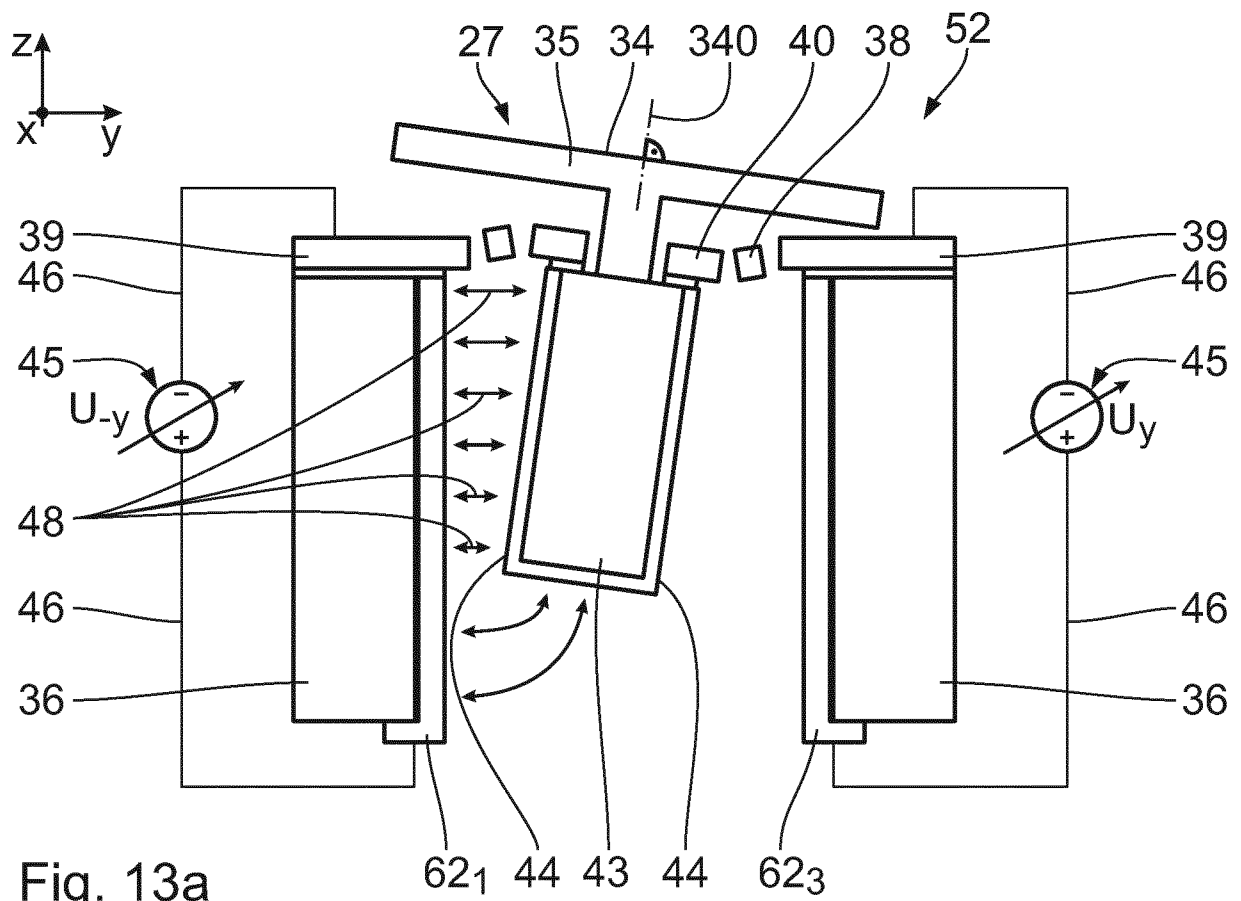


Fig. 13a

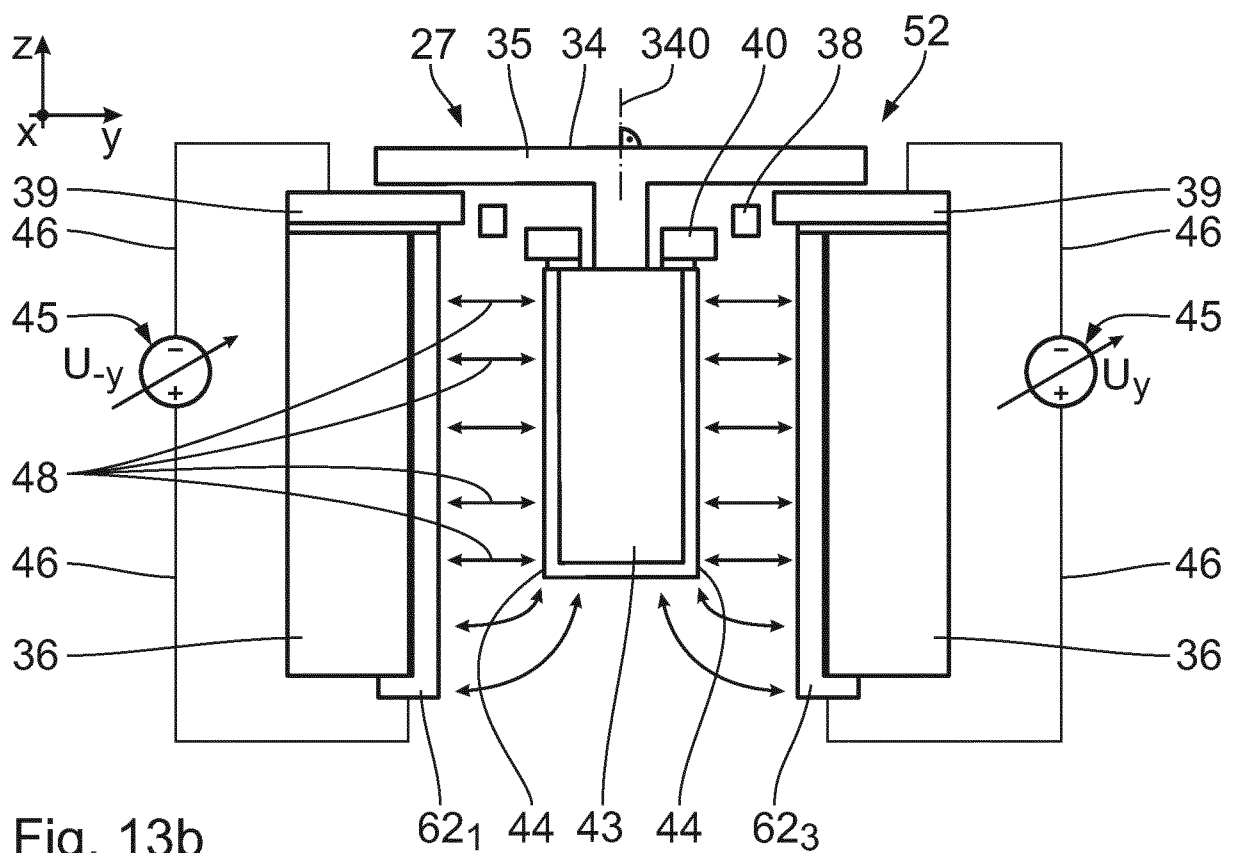
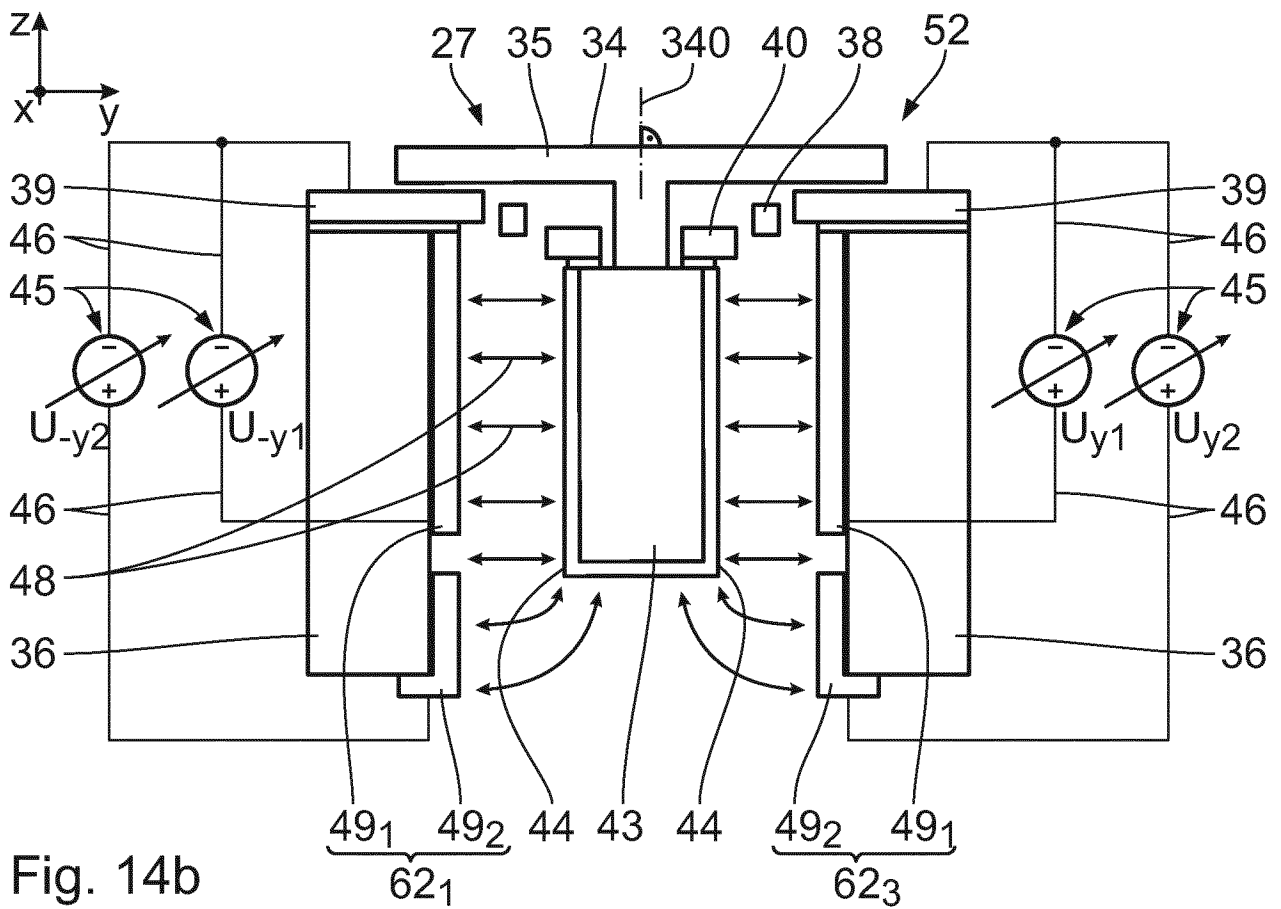
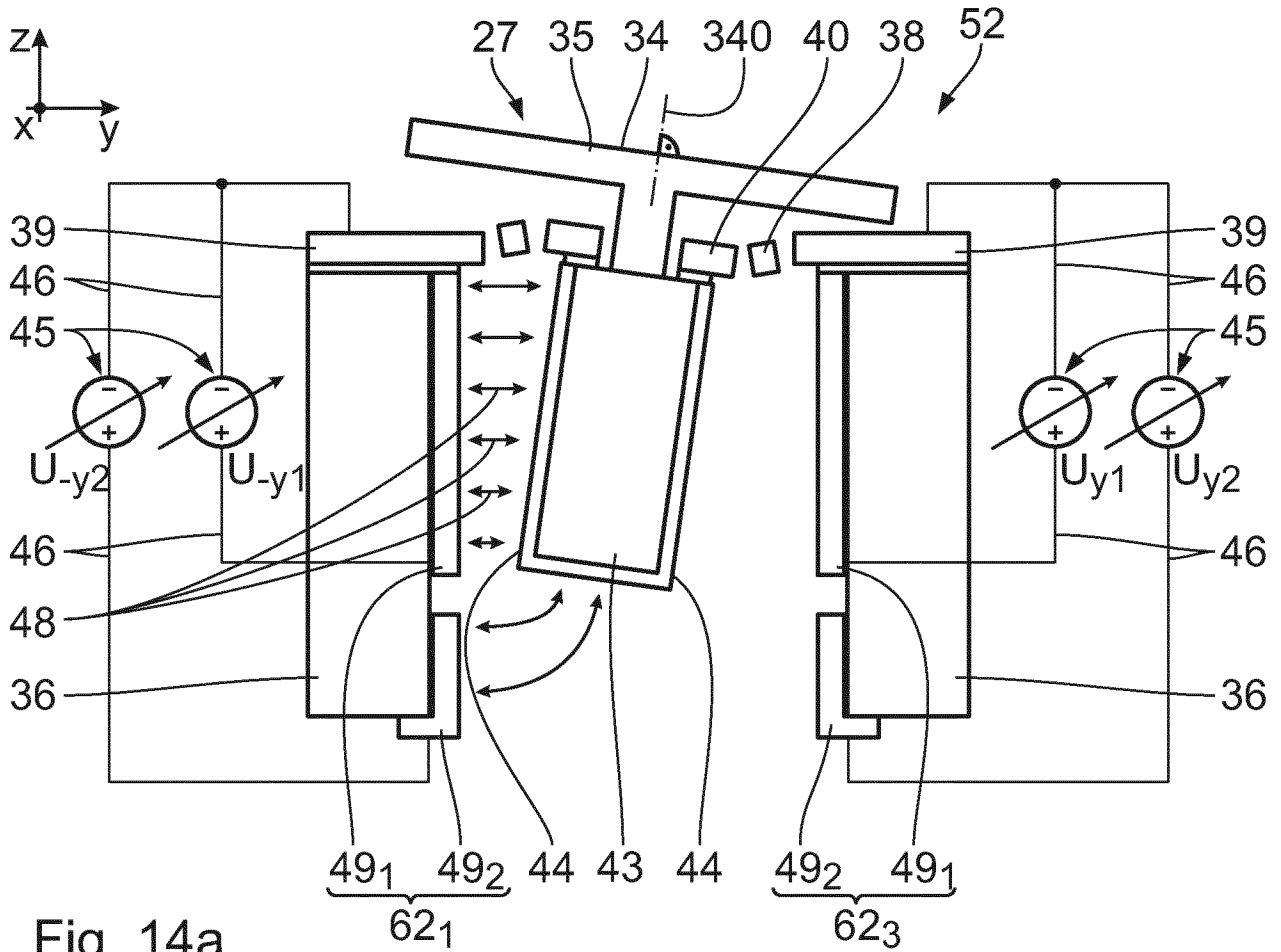


Fig. 13b

9/21



10/21

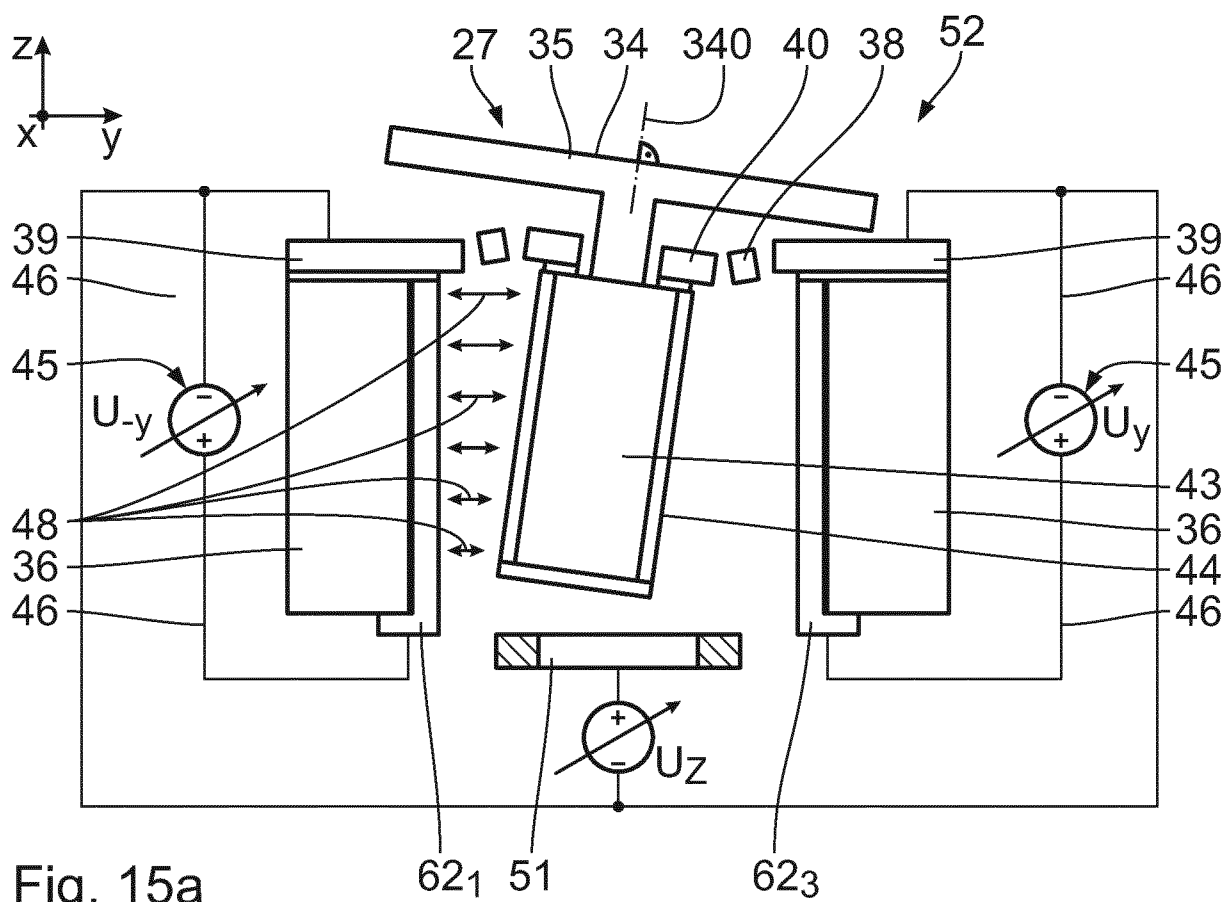


Fig. 15a

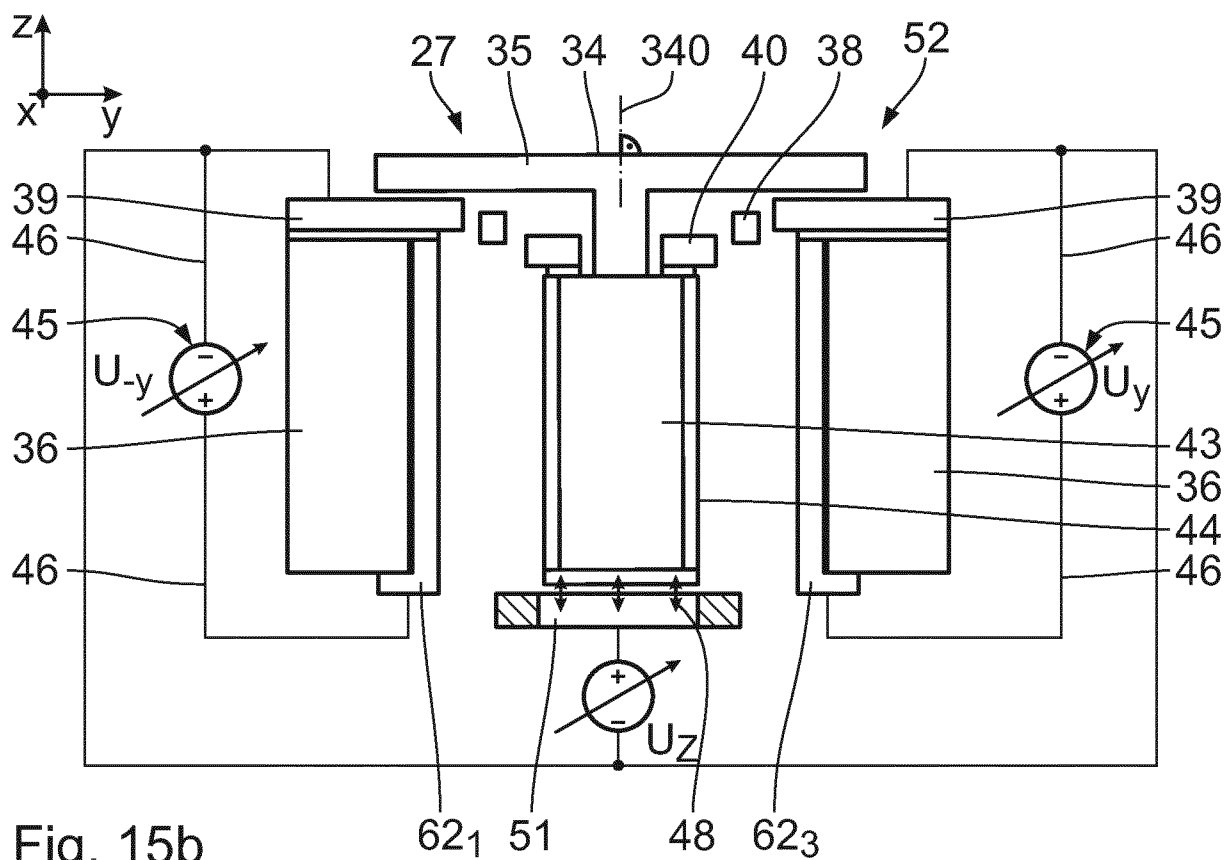


Fig. 15b

11/21

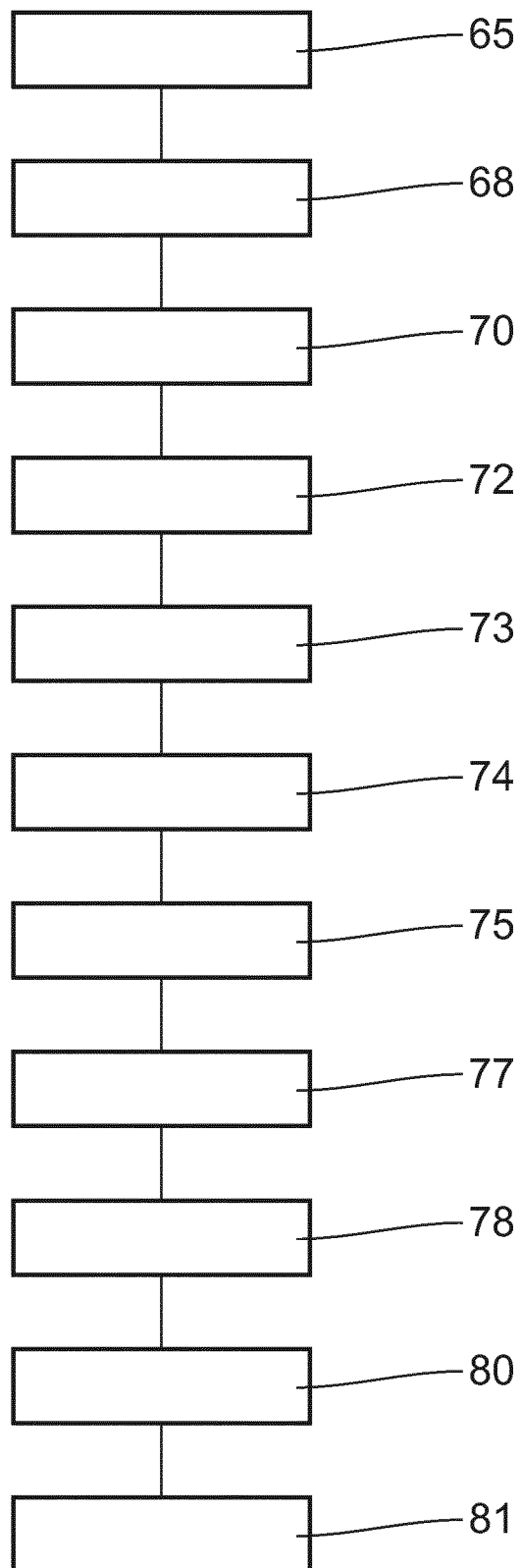


Fig. 16

12/21

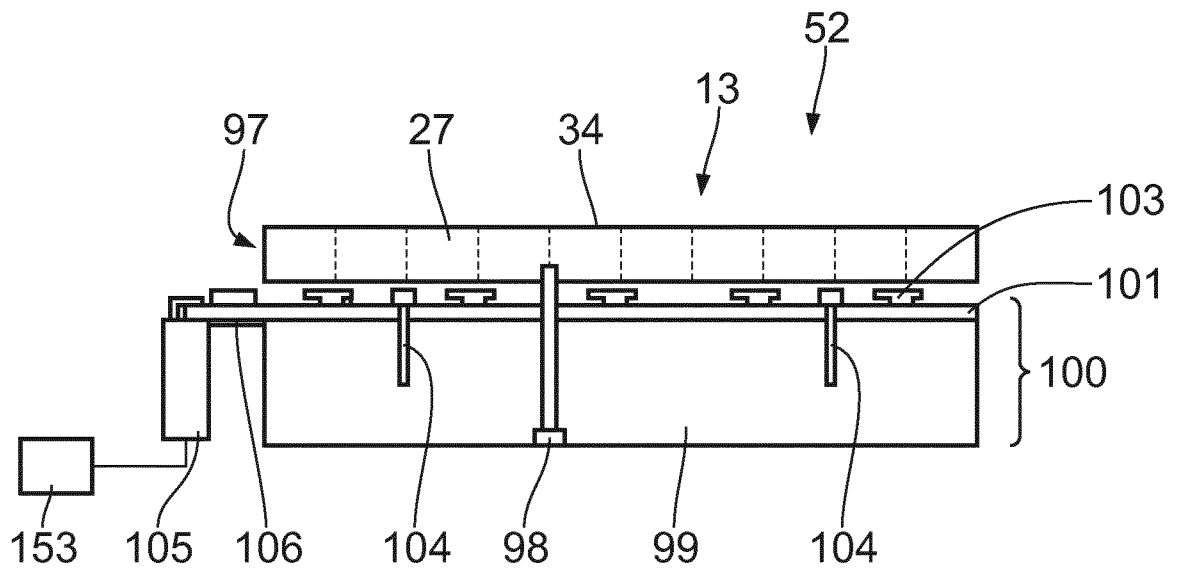


Fig. 17

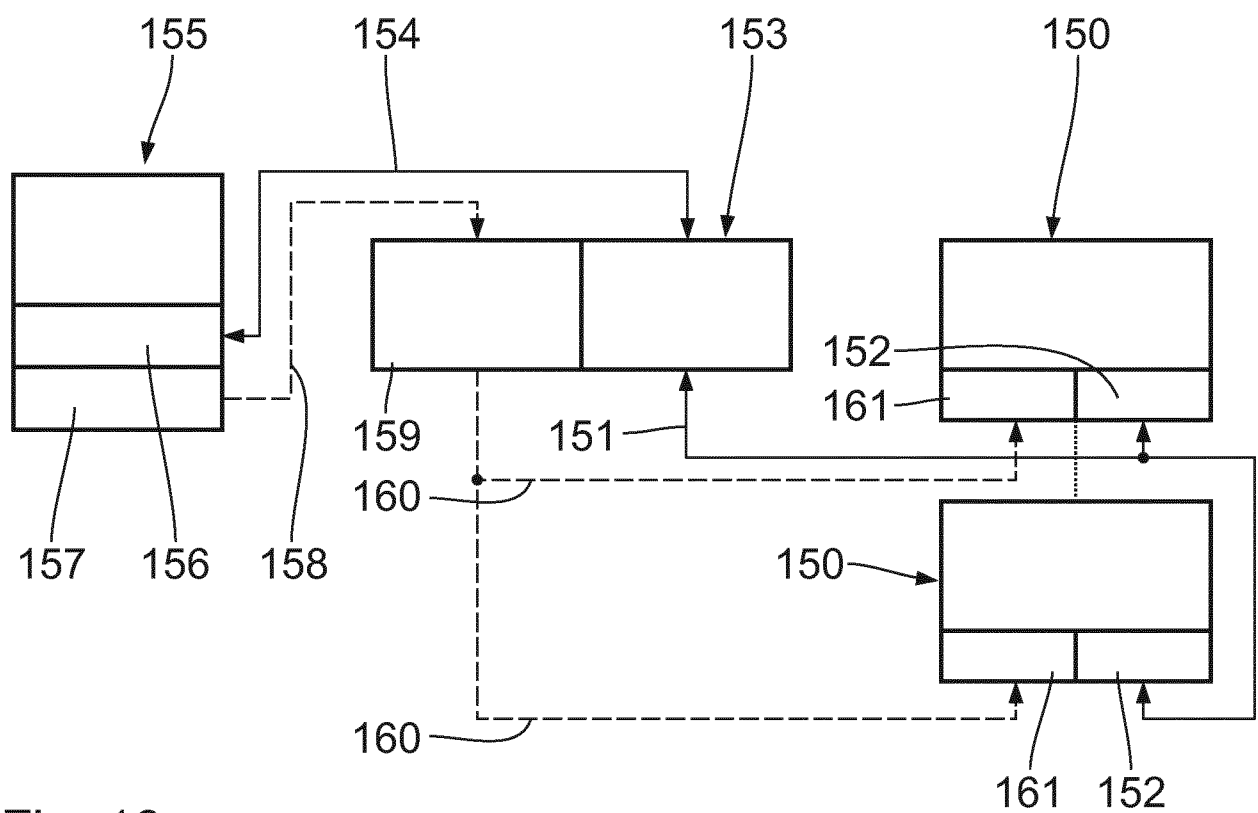


Fig. 18

13/21

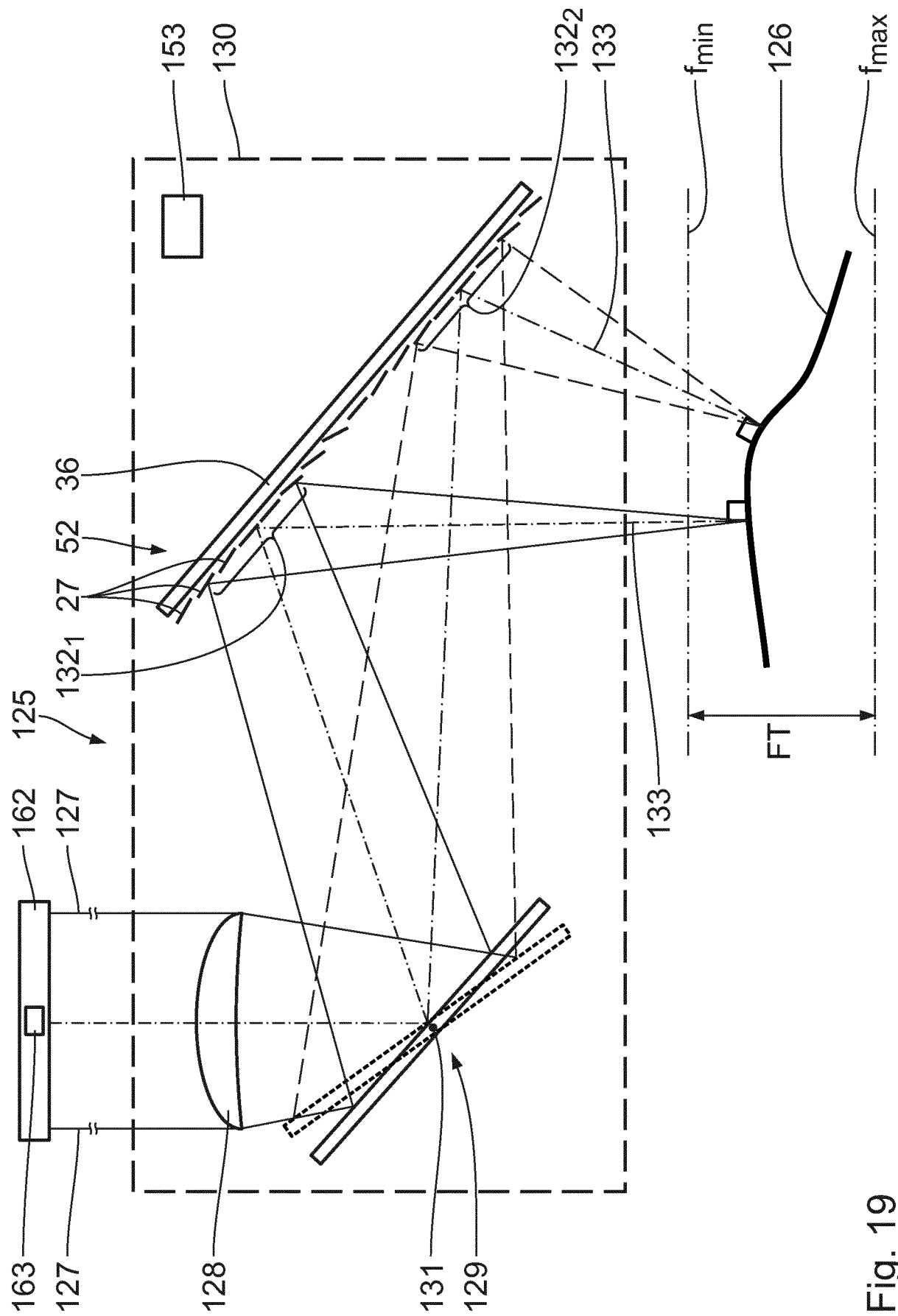


Fig. 19

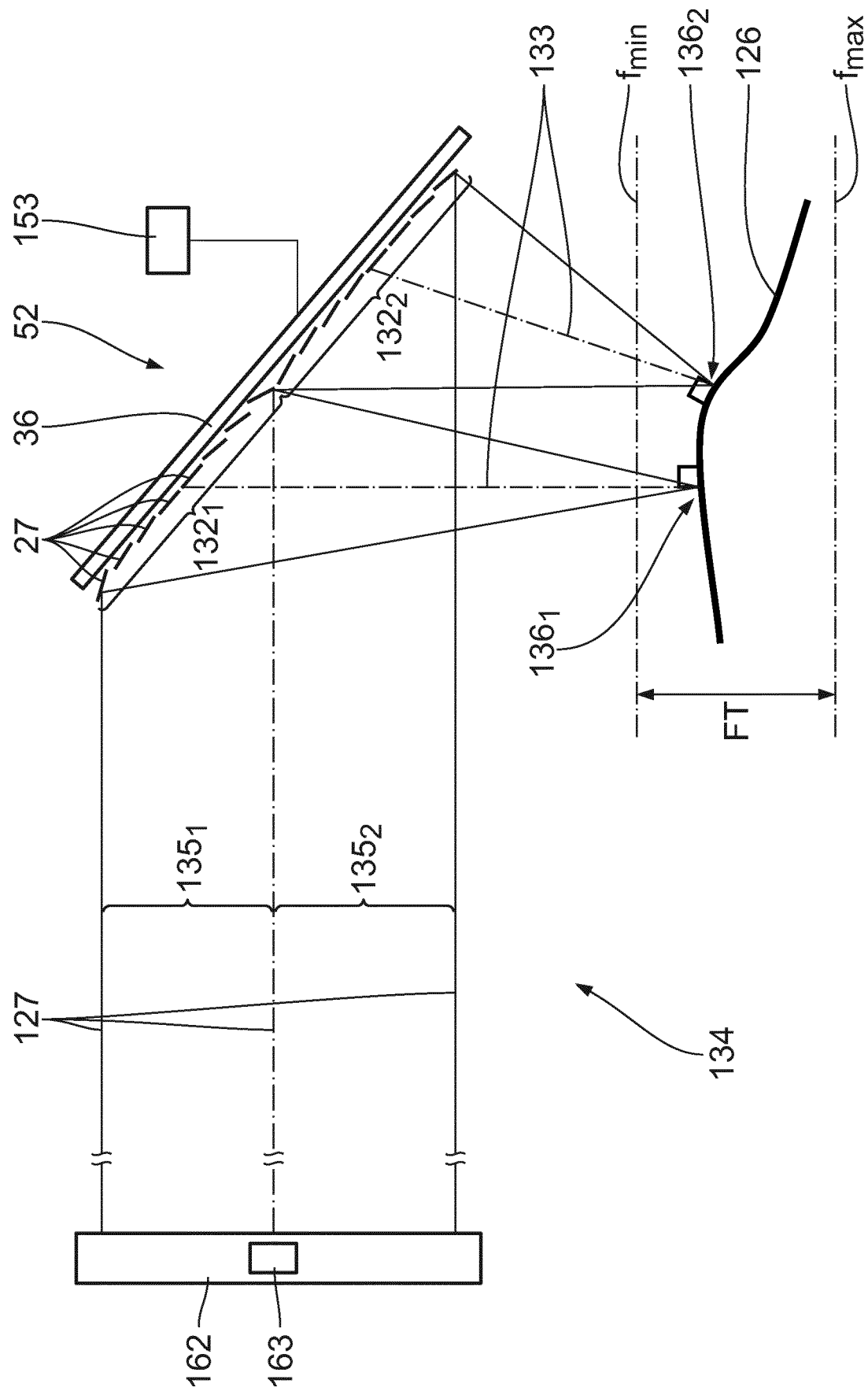


Fig. 20

15/21

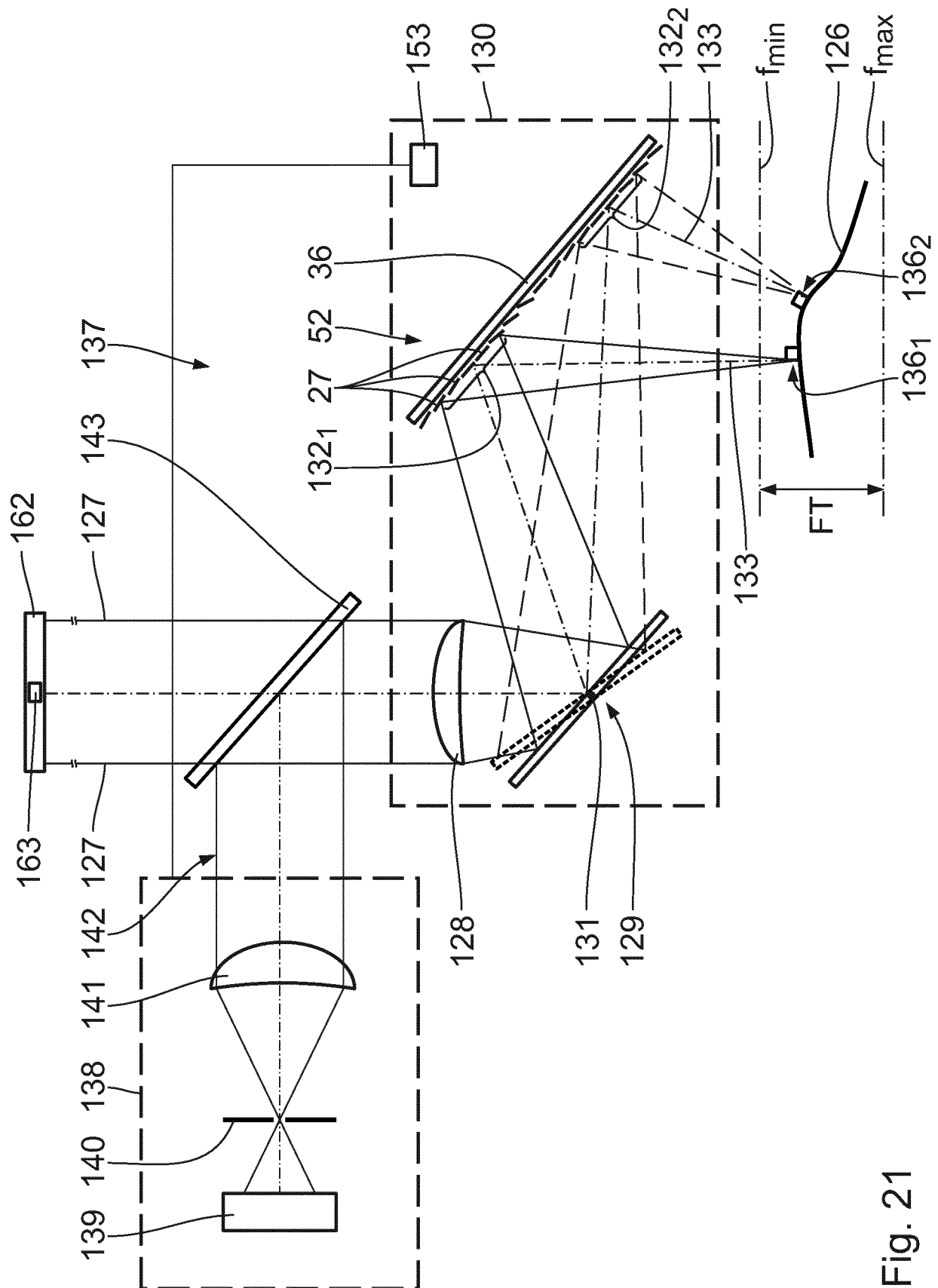


Fig. 21

16/21

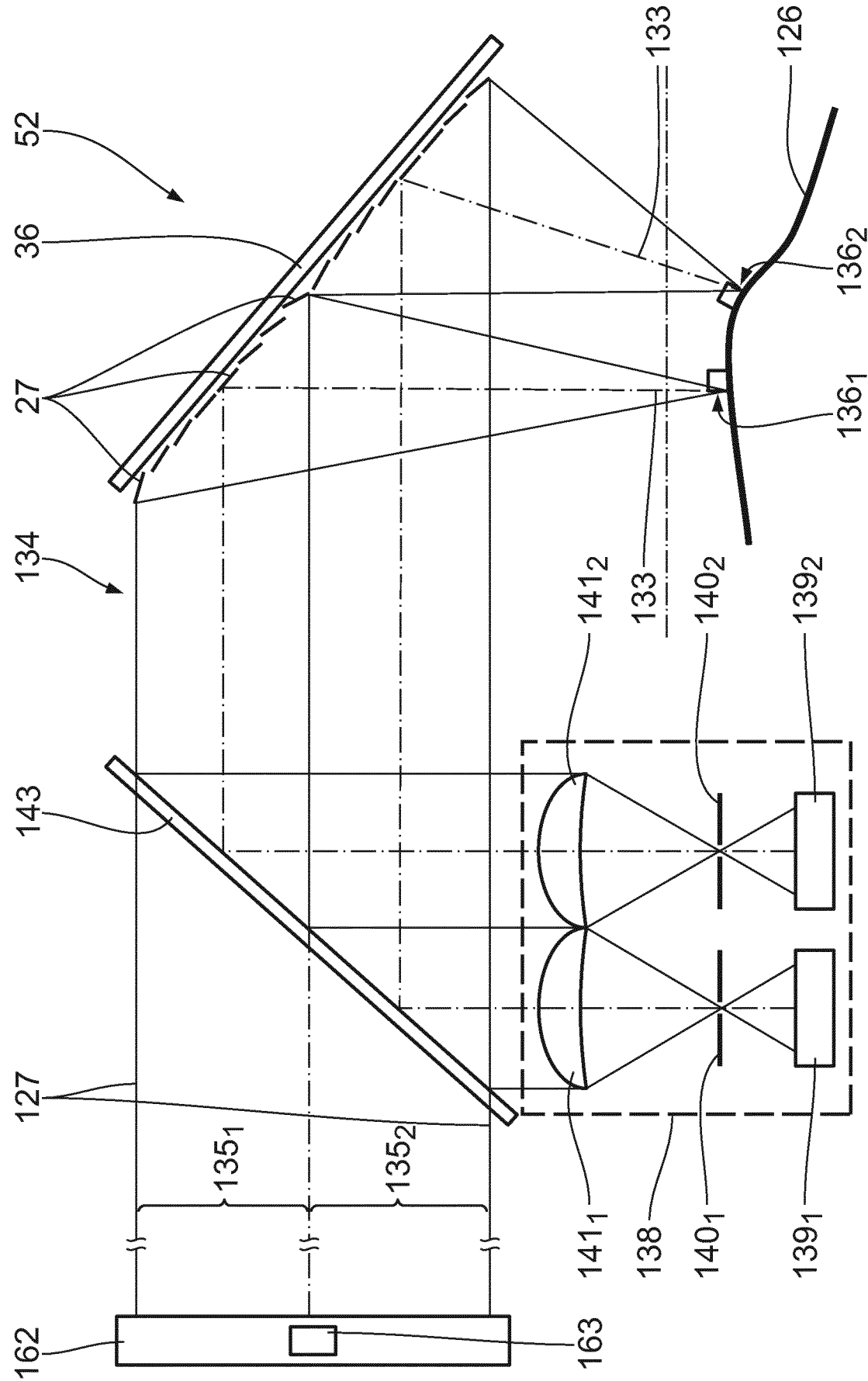


Fig. 22

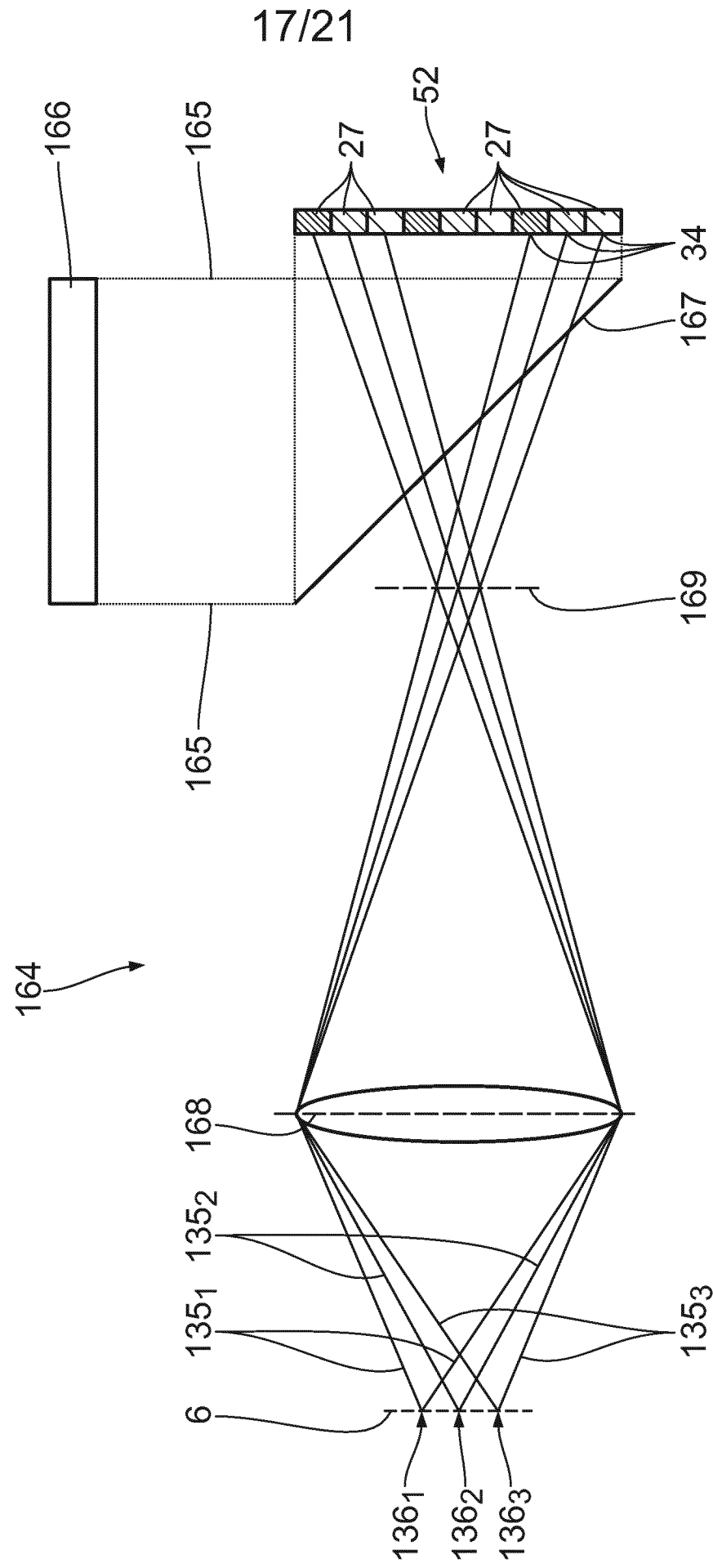


Fig. 23

18/21

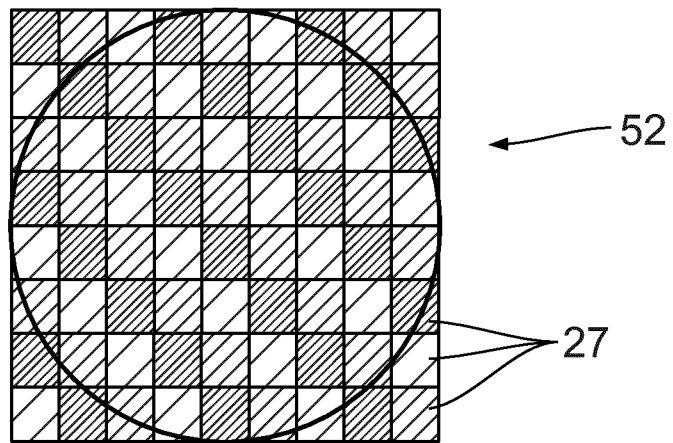


Fig. 23a

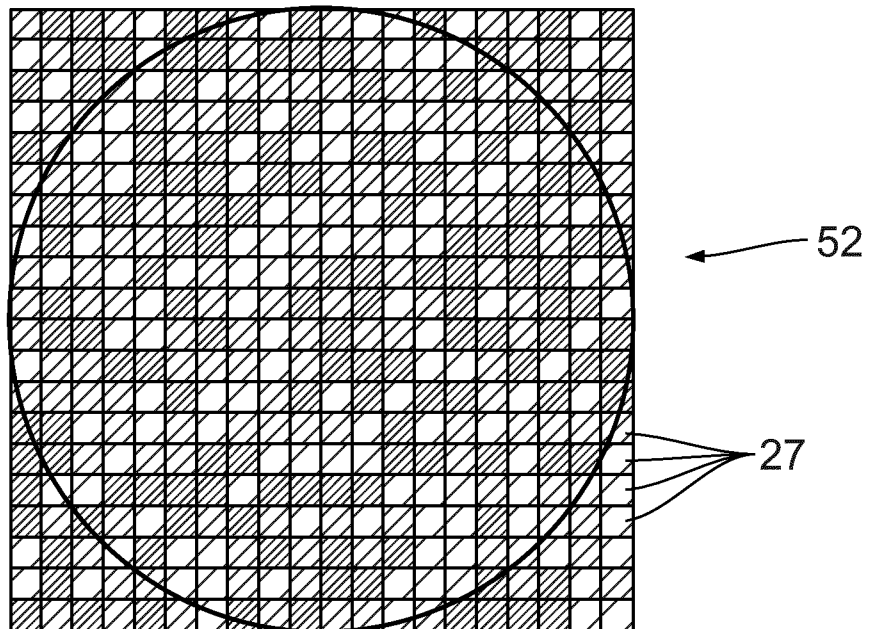


Fig. 23b

19/21

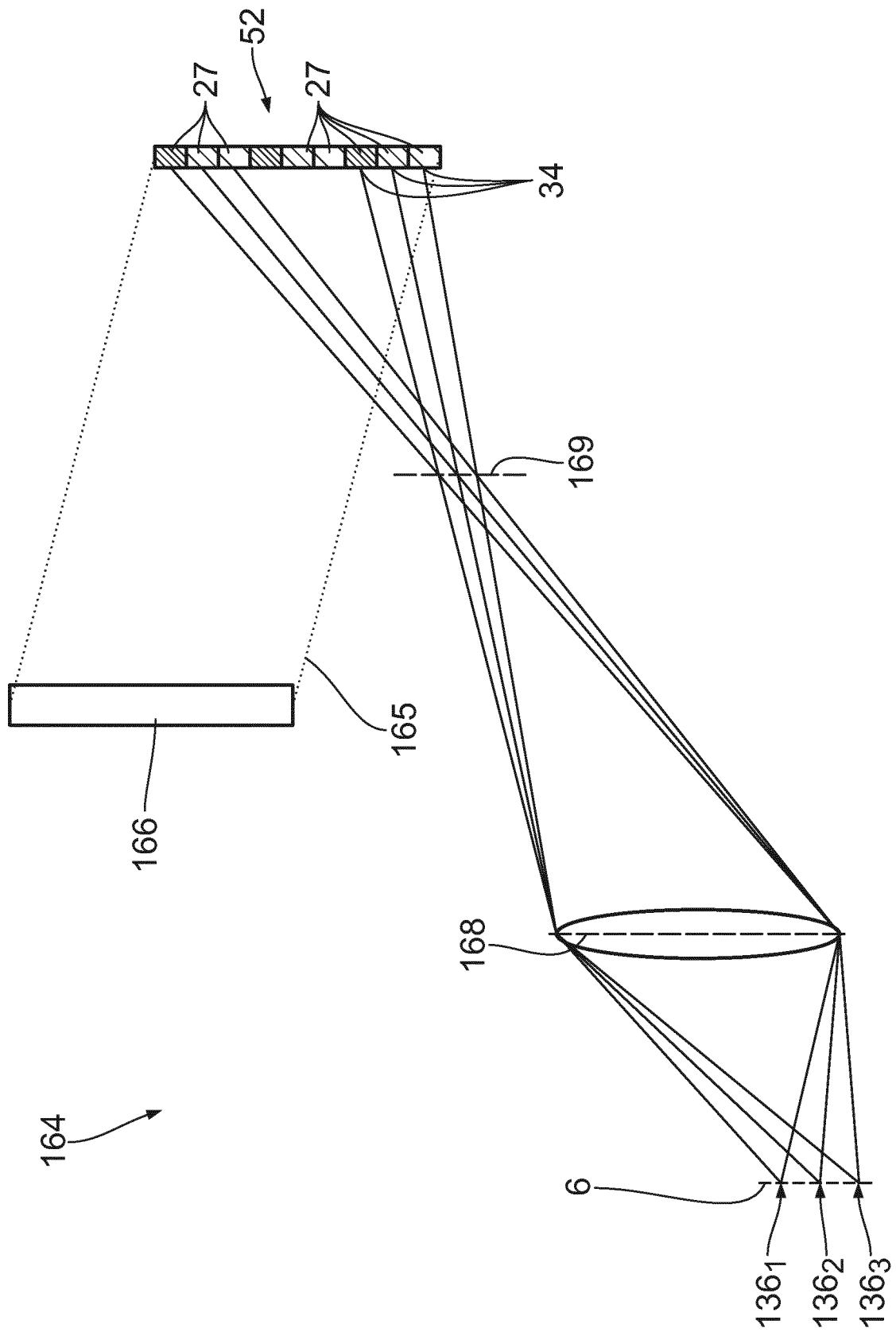


Fig. 24

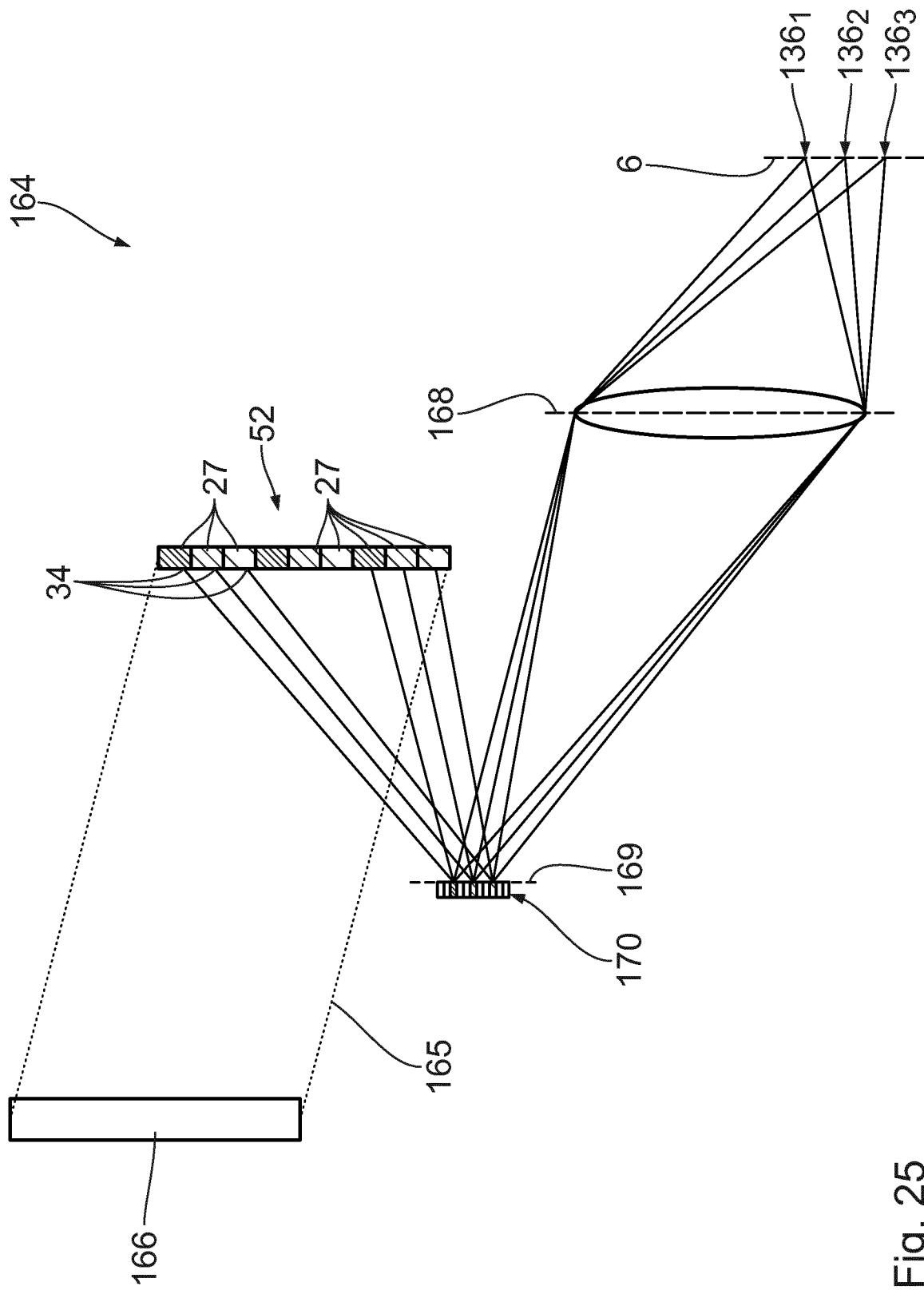


Fig. 25

21/21

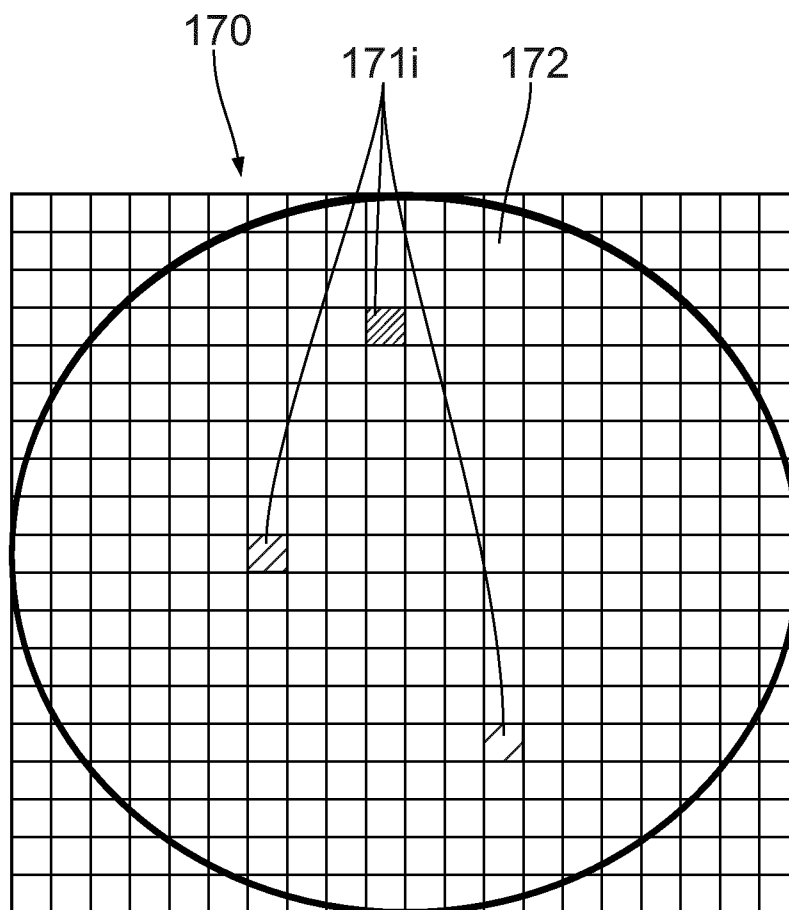


Fig. 26

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No

PCT/EP2013/057824

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
 INV. G02B26/08
 ADD.

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
 G02B

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

EPO-Internal

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	EP 1 471 372 A1 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD [JP] PANASONIC CORP [JP]) 27 October 2004 (2004-10-27) figures 1-6	1-15
X	US 2008/049291 A1 (BAEK SANG H [KR] ET AL BAEK SANG HYUNE [KR] ET AL) 28 February 2008 (2008-02-28) figures 1-28	1-15



Further documents are listed in the continuation of Box C.



See patent family annex.

* Special categories of cited documents :

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

25 June 2013

Date of mailing of the international search report

05/07/2013

Name and mailing address of the ISA/

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
 NL - 2280 HV Rijswijk
 Tel. (+31-70) 340-2040,
 Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Daffner, Michael

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No

PCT/EP2013/057824

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
EP 1471372	A1	27-10-2004	CN 1701255 A 23-11-2005
			EP 1471372 A1 27-10-2004
			JP 4164450 B2 15-10-2008
			US 2005152019 A1 14-07-2005
			WO 03065103 A1 07-08-2003

US 2008049291	A1	28-02-2008	NONE

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES

INV. G02B26/08

ADD.

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

G02B

Recherchierte, aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	EP 1 471 372 A1 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD [JP] PANASONIC CORP [JP]) 27. Oktober 2004 (2004-10-27) Abbildungen 1-6	1-15
X	US 2008/049291 A1 (BAEK SANG H [KR] ET AL BAEK SANG HYUNE [KR] ET AL) 28. Februar 2008 (2008-02-28) Abbildungen 1-28	1-15



Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen



Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

"E" frühere Anmeldung oder Patent, die bzw. das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

25. Juni 2013

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

05/07/2013

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Daffner, Michael

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2013/057824

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP 1471372	A1	27-10-2004	CN 1701255 A 23-11-2005
			EP 1471372 A1 27-10-2004
			JP 4164450 B2 15-10-2008
			US 2005152019 A1 14-07-2005
			WO 03065103 A1 07-08-2003

US 2008049291	A1	28-02-2008	KEINE
